金属磁性とエキゾチック超伝導の最近の展開

<u>吉村</u>一良¹*, 今井正樹¹, 松元卓也¹, 原口祐哉¹, Swee K. Goh², 太田寛人³, 道岡 千城¹, 植田 浩明¹ ¹京都大学 大学院理学研究科 化学専攻 化学教室 ²Cavendish Laboratory, University of Cambridge, U. K. ³東京農工大学 大学院工学研究院 工学部 システム工学科 *E-mail: kyhv@kuchem.kyoto-u.ac.jp

磁性と超伝導の研究は歴史的に相互に密接に関連し合いながら 発展してきた.このことは物質探索の面からも言え,超伝導体探索の副産物として,典型 的な弱い金属磁性体(遍歴電子磁性体)が発見された経緯がある.このような範疇の物質 群は金属磁性(遍歴電子磁性)の発展に大きく貢献し,スピンの揺らぎの概念の大きな発 展・展開がもたらされた.超伝導の分野でも,格子振動(フォノン)が電子間引力の起源 とする,いわゆる BCS 超伝導体以降,重い電子系超伝導体,有機超伝導体,銅酸化物高温

超伝導体が発見され、新物質の探索・ 発見が超伝導研究の発展に大きく貢献 してきている. このような電子相関の 強い系での超伝導では、

超伝導相が磁 性相と必ず隣接して存在しており(典 型的な例を図1 に示す[1]),磁気的な 相互作用(スピン揺らぎ)を媒介した 電子間引力による超伝導機構が提案さ れている(遍歴電子磁性と密接に関 係). このような従来型(BCS型)で はない超伝導は, エキゾチック超伝導 と言われ,非常に興味を持たれ注目さ れてきている. その後, パイロクロア 系超伝導体や含水層状三角格子コバル ト酸化物超伝導体(図1参照)が、最 近では層状鉄ニクタイドやカルコゲナ イドの超伝導体が発見され、この研究 分野では次々と多くの新しいエキゾチ ック超伝導体の発見が相次ぎ賑わって



図 1 含水層状三角格子コバルト酸化物超伝導 体 $Na_x CoO_2 \cdot y H_2O$ の電子相図 [1]. ここで, 縦軸 T_c は超伝導転移温度,または,強磁性 転移温度,横軸 v_{Q3} は Co の核四重極共鳴 (NQR)の共鳴周波数を表し, SC-1, II は超 伝導相を, M は金属強磁性相を表す.

いて(磁気的な相互作用ではなくても,カゴ状化合物のラットリング機構による超伝導な ども興味深い[2]),二次元系での高温超伝導の発現と,それに関連した二次元遍歴電子強 磁性体の系の展開が注目される.

本公演では,最近の遍歴電子磁性の展開と問題点,エキゾチック超伝導の最近の動向に ついて,発表者の私見ではあるがレビューしたい.

References (文献)

- [1] H. Ohta, K. Yoshimura, Z. Hu,¹ Y. Y. Chin,¹ H. -J. Lin,² H. H. Hsieh,² C. T. Chen,² and L. H. Tjeng,¹ *Phys. Rev. Lett.* 107, 066404/1-5 (2011).
- [2] Lina E. Klintberg, Swee K. Goh, Patricia L. Alireza, Paul J. Saines, David A. Tompsett, Peter W. Logg, Jinhu Yang, Bin Chen, Kazuyoshi Yoshimura, and F. Malte Grosche, *Phys. Rev. Lett.* 109, 237008/1-5 (2012).



2次元空間に閉じ込めたヘリウムの量子物性

福山 寛東京大学 大学院理学系研究科 物理学専攻東京大学 低温センターE-mail : hiroshi@phys.s.u-tokyo.ac.jp



一般に物質は、低温になるにつれ気体→液体→固体と状態変化する. ヘリウムのように 構成粒子の質量が小さい場合、粒子間相互作用に比して量子力学的な零点振動エネルギー が無視できず、常圧下では絶対零度でも固化しない. その結果、低温で量子液体状態が実 現し、超流動をはじめ数々の興味深い量子多体現象を示す.本講演では、ヘリウム原子の 運動を2次元空間に閉じ込めた物質系が示す新奇な量子現象をいくつか紹介する.

2 次元系は近接粒子数が少ないので、運動エネルギーの効果が相対的に大きく、絶対零度で液化すらしない可能性がある.実際、これまでの理論計算は、ヘリウム 4 (⁴He)の 2 次元系は自己凝縮するが、ヘリウム 3 (³He) は凝縮せず、基底状態で量子気体にとどまる物質と考えられてきた.ごく最近、我々はグラファイト表面に物理吸着した ³He 単原子層膜が、ごく小さいが有限の臨界密度 ($\rho_c = 0.6 \text{ nm}^2$)をもつ自己束縛状態を作る(液化す

る)ことを、フェルミ縮退温度より十分低温の熱容量測定 から明らかにした[1]. 平均粒子面密度が ρ_c より小さくなる と、系は密度 ρ_c の液体とそれよりずっと希薄な気体(T = 0では真空)に2相分離する(図 1).液体と気体を区別す るのは、それ以下の密度が存在しないという ρ_c があるか否 かである. $\rho_c = 0.6 \text{ nm}^2 \sigma 2 次元液体 ³He は、自然界で最も$ 希薄な(平均粒子間距離が大きな)液体である.理論と実験の不一致が何に起因するのか、いまその検証が進んでいる.ところで、液化するほどの引力があるということは、超低温で BCS 転移が観測される期待も膨らむ.



図1 2次元ヘリウム3の 自己凝縮.

次に、³He 単原子層の面密度を増してゆくと、下地層の結晶構造に整合な固体相が現れ る.これは、下地の周期ポテンシャル、粒子間相関(剛体球斥力)、運動エネルギーの間 の微妙なバランスの結果、生ずる非常に低密度な三角格子の量子固体(4/7 相)である. そのため多原子のトンネル交換が競合して、ギャップレスの量子スピン液体状態が現れる. それまで 1 次元の反強磁性鎖の磁気基底状態として理論的にのみ知られていたこのエキゾ ティックな磁性は、16 年前に我々が ³He-4/7 相で初めて実験的に見出したものである[2]. その後、同様の磁性が擬 2 次元有機物質や 3 次元ハイパーカゴメ物質などの電子スピン系 でも見出され、フラストレーションのある強相関フェルミ粒子系の局在点近傍に現れる普 遍的な磁性の可能性も議論されている.

一方,ボース粒子系の⁴He-4/7 相は,未発見の「超固体」現象の有力な舞台である.これは,4/7 相がようやく局在したフラフラした量子固体だからである.ところが,最も精度が高いと思われる最新の量子モンテカルロ計算では,この⁴He-4/7 相は安定化しないと主張されていた.最近我々は,この系の熱容量と蒸気圧測定を行い,4/7 相の存在を強く示唆する実験結果を得た[3].こうした2次元超固体現象の探索実験についても紹介する.
[1] D. Sato, K. Naruse, T. Matsui, and H. Fukuyama, Phys. Rev. Lett. **109**, 235306 (2012).
[2] K. Ishida, M. Morishita, K. Yawata, and H. Fukuyama, Phys. Rev. Lett. **79**, 3451 (1997).
[3] S. Nakamura, K. Matsui, T. Matsui, and H. Fukuyama, to be published.

自然界の三角関係:スピンフラストレーションの物理

前川 覚 京都大学 人間・環境学研究科 相関環境学専攻 京都大学低温物質科学研究センター E-mail:maegawa.satoru.3w@kyoto-u.ac.jp



人間社会において三つどもえの争いは二者間の争いよりもやっかいで,解決が難しい. 一方,三人寄れば文殊の知恵といわれるように,三者が協議すると予想もしなかった名案 が生まれることがある.自然界にも三角関係が存在し,これまで知られていなかった興味 深い新しい状態や現象が出現してくる.

図1 に示すように正三角形の頂点に位置するスピン間に,互いに 反平行に整列しようとする反強磁性相互作用が働いていると,どの 二体間もその条件を満足した整列状態は存在し得ない.これは,絶 対零度において系は秩序化した唯一の最低エネルギー状態をとり, エントロピーが零になるという熱力学第三法則に反することになる. このように相互作用の競合により,秩序化が抑制される効果は心理 学用語を流用してフラストレーション効果と呼ばれている.フラス トレーションは図2 に示すような三角格子,図3 のかごめ格子,さ らに三角形から成る四面体が頂点を共有して連結した図4 に示すパ イロクロア格子等からなる磁性体において実現され,新しい興味深 い状態や現象が発見,提案されている.

フラストレート磁性体の理想的モデルでは基底状態に巨視的数の 縮退状態が存在しうる.フラストレート磁性体の性質は格子構造の 違いの他に、イジング型か、XY型か、ハイゼンベルグ型かというス ピン間相互作用の種類によっても大きく異なる.また、磁気異方性や 他の微弱な相互作用が系の秩序化に大きな影響を与える.通常の磁性 体では見られない部分秩序や成分秩序をなす中間相を経てフェリ磁性 秩序や120°スピン秩序に到る逐次相転移がその典型例である.



さらに、スピンが 1/2 の系の場合にはフラストレーション効果に量 子効果が加わり、古典ベクトルスピン系とは大きく異なるスピン状態が期待される.実際、 量子スピン三角格子反強磁性体においては二つずつのスピンがシングレット対を形成し、 格子上を動き回るという量子スピン液体が発現すると提案され、注目を集めてきた.

本講演では、これまで我々が核磁気共鳴法を用いてミクロな観点から研究してきた各種 フラストレート磁性体におけるスピン状態や秩序化過程、スピン揺動を紹介する.特に 我々は最近、有機系量子三角格子反強磁性体において、相互作用の1万分の1の20mK ま で磁気秩序が起こらず、量子ゆらぎにより量子スピン液体が実現していることを発見した. さらに、1K において核スピン緩和率の大きな変化を見つけ、新たなスピン液体状態に相 転移しているものと考えられる [1, 2]. また、パイロクロア格子磁性体においても特異な 逐次相転移を見いだし、そのスピン状態を解明した [3].

[1] T. Itou, A. Oyamada, S. Maegawa, et al., Phys. Rev. B 77, 104413 (2008).

[2] T. Itou, A. Oyamada, S. Maegawa and R. Kato, Nature Phys. 6, 673 (2010).

[3] S. Maegawa, A. Oyamada, and S. Sato, J. Phys. Soc. Jpn. 79, 011002 (2010).

P1 ヘリウム4吸着2層グラフェンの磁気輸送特性

<u>福田昭</u>^a, 寺澤大樹^a, 大野恭秀^b, 松本和彦^b, 澤田安樹^c, 矢山英樹^d ^a兵庫医科大学物理学教室 ^b大阪大学産業科学研究所 ^c京都大学低温物質科学研究センター ^d九州大学理学研究院

E-mail : fuku@hyo-med.ac.jp

グラフェン中に存在する2次元電子系では,質量ゼロの相対論的ディラック・フェルミ オンが活躍する他,2次元電子系を表面から直接観測したり,分子修飾などにより直接変 調を加えたりすることのできる興味深い系である.本研究は,グラフェン表面に原子・分

子修飾させることにより,2次元電子系に核スピン自由度を付加したり,弱磁場下での局在効果や, 強磁場下で変調された量子ホール効果を観測したりすることを目的としている.

本研究では、吸着原子層数を制御して、2層グ ラフェンの磁気抵抗変化を観測した. 図では、温 度 7 K、ディラック点近傍で、⁴He ガスを1層分 グラフェンに吸着させ、磁気抵抗の変化量 ΔR_{xx} を ゲート電圧 V_g および磁場 B の関数として観測し た. 低温・弱磁場で観測される量子振動に対応し て、抵抗値がわずかに増減する様子が観測された. また、磁気抵抗の変化量が、吸着層数に応じて増 加する傾向にあることも分かった.



図 ⁴He 吸着下での磁気抵抗の変化 ΔR_{xx} の ゲート電圧 V_{g} 一磁場 B 依存性

P2 動的核スピン偏極による量子ホール効果の絶縁体転移

福田昭^a,津田是文^b,寺澤大樹^a,澤田安樹^c

^a兵庫医科大学物理学教室, ^b京都大学大学院理学研究科,

°京都大学低温物質科学研究センター

E-mail : fuku@hyo-med.ac.jp

動的核スピン偏極(Dynamic Nuclear Polarization, DNP)を用いて半導体中の核スピンを 偏極させることは、量子計算機などのスピントロニクス・デバイスにおいて、大きな興味 を集めている.量子ホール系では、v=2/3 分数量子ホール状態でスピン転移があり、転移 点付近で大電流を流すことにより、超微細相互作用を通した電子スピン反転に伴う DNP が生じることが知られている.DNP 後は、巨大な磁気抵抗を伴う状態(Resistance

Enhanced State, RES) になるが, RES の本質的性質及 び発生機構については知られていなかった.本研究 では, DNP 後にすばやい温度測定を行う手法を開発 し, RES での磁気抵抗の温度依存性の測定に初めて 成功した. 図は, DNP 前後での磁気抵抗の温度依存 性であるが, DNP 前は,量子ホール状態の温度依存 性を示すのに対し, DNP 後は絶縁体の温度依存性を 示していることがわかる.交流会では,アンダーソ ン局在と RES との関連についても報告する予定であ る.



図 v=2/3 量子ホール状態で DNP を行 う前後での磁気抵抗 R_{xx}の温度依存性





P3 独立2層コンタクト素子の測定と今後の展望

<u>寺澤 大樹</u>^a, 三谷 昌平^b, 福田 昭^a, 澤田 安樹^c, ^a兵庫医科大学 物理学教室 ^b京都大学 大学院理学研究科 ^c京都大学 低温物質科学研究センター



GaAs/AlGaAs ヘテロ接合による2層系試料は、通常上層と下層がオーミックコンタクト でつながった構造を持つため、それぞれの層の抵抗を独立に測定することは不可能である. しかし、層間コヒーレンスを持つと考えられる2層系v=1 量子ホール状態などは、2層間 に流れる層間のトンネリング電流の測定が重要な実験結果をもたらす.そこで、2層独立 にコンタクトを持った試料の作製に成功した Max-Planck 研究所から試料の提供を受け、 層間トンネリング電流の測定を目指して測定を行った.

図 1 は磁気抵抗 *R_{xx}* およびホール抵抗 *R_{xy}* の磁場 *B* 依存性である.オーミックコンタクトの不良により, 低温,2T 以上で *R_{xx}* が発散し,測定できなくなった. 発表では試料の構造や課題,期待される結果(AC ジョ セフソン効果やシャピロステップ)及び今後の展望に ついて述べたい.

本実験は独国 Max-Planck 研究所 W. Dietsche 教授, L. Tiemann 博士の協力を得て行われた. ここに深く 感謝したい.



P4 2層グラフェンにおける弱局在効果

<u>寺澤 大樹</u>^a, 福田 昭^a, 大野 恭秀^b, 松本 和彦^b, 澤田 安樹^c, 矢山 英樹^d

^a兵庫医科大学 物理学教室 ^b大阪大学 産業科学研究所 ^c京都大学 低温物質科学研究センター ^d九州大学 理学研究院 E-mail:terasawa@hyo-med.ac.jp

グラフェンとは炭素が蜂の巣状に格子を組んだ 2 次元系で,分散関係が線形で質量ゼロ の準相対論的 Dirac フェルミオンの特徴を持つ. グラフェンは表面が露出しているため, 基板の凹凸による散乱を受けやすく,散乱経路によっては量子補正効果による弱局在を起 こし,抵抗値に磁場がゼロのとき極大が現れる.しかし,出現する条件など詳細は不明で ある.そこで,本研究では酸化膜付き Si 基板上の 2 層グラフェン試料(移動度約 2500cm²/Vs)の弱局在効果について調べた.

図 1 は縦抵抗のゲート電圧に対する変化について温度を変えながら測定した結果である. Dirac 点(電荷中性点)において抵抗値が極大を示し,冷却によって抵抗が大きくなる絶縁体的な変化を示した.さらに 11K 以下において抵抗値が振動を繰り返すようになった.この振動は弱磁場で抵抗が下がるという弱局在の特徴を示すこと,振動の極大の方が大きな抵抗減少を示すことがわかった.発表では結果について理論との比較を行う.



図1 縦抵抗値のゲート電圧依存性の 温度変化.





P5 量子ホール状態v=2/3における抵抗増大現象の周波数依存性

<u>津田是文</u>^a,福田昭^b,寺澤大樹^b,澤田安樹^c ^a京都大学大学院理学研究科,^b兵庫医科大学物理学教室, ^c京都大学低温物質科学研究センター

E-mail : shibun@scphys.kyoto-u.ac.jp

ランダウ準位占有率 v=2/3 量子ホール状態では、スピンの異なる 2 つの電子状態が縮退 する時、試料内に異なるスピン状態のドメイン構造が形成され、大電流を流すと磁気抵抗 が増大する事が知られている.しかし、電流を流す事による抵抗増大のメカニズムや、ド メイン構造のダイナミクス等は明らかになっていない.我々は、抵抗増大を起こす電流に

着目し、電流の周波数によってどのように抵抗増 加が変化するかを測定した.図は、60 nAの大電 流をさまざまな周波数の方形波で一定時間

(pumping time) 印加し, 5 nA, 37.7 Hz の電流で 磁気抵抗値を短時間測定したものである. 交流電 流を用いた時は抵抗が単調増加するのに対し, 周 波数を小さくすると抵抗増加が弱まり, 特に直流 電流を用いた時は抵抗が一度増加した後減少し脈 動する極めて特異な様子が見られた. 交流会では 電流周波数によって抵抗増加のメカニズムがどの ように変わるかについて議論する.



電子ホール状態V-2/3 においていてうか の周波数の電流を流したときの磁気抵抗 値の時間変化.

P6 分数量子ホール効果における磁気抵抗増大状態の占有率依存性

<u>三谷 昌平</u>^a, 津田 是文^a, 寺澤 大樹^b, 福田 昭^b, 澤田 安樹^c

*京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野

^b兵庫医科大学 物理学教室

⁶京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : mitani@scphys.kyoto-u.ac.jp

ランダウ準位占有率 v = 2/3 量子ホール効果においては、電子スピン偏極相と非偏極相と の境界付近で大きな電流を流すことにより、核スピン偏極を伴う磁気抵抗の増大が起こる ことが知られている.

本研究では,磁場と電子密度を固定して電流を流 し続け,核スピン偏極が飽和した磁気抵抗増大状態 を生成し、この抵抗増大が

0.52<*v* < **0.72** という限られた領域でのみ生じることが明らかになった.

また測定電流により温度依存性を判別する方法を 開発し,抵抗増大状態においてさらに素早く電子密 度を変化させることで磁気抵抗の占有率依存性を測 定した.交流会では各量子ホール相に別の相のドメ インが出現することで不純物となり電子系を局在化 させるというメカニズムについて発表する予定であ る.



図1 v=0.64 での電流ポンプによる偏極 前(点線),後(実線)の磁気抵抗の占有率に 対するプロット



P7 重い電子系超伝導体 CeCoIn₅の面内トンネル接合の作製

<u>中村 昌幸</u>^a, 下澤 雅明^a, 安元 智司^a, 綿重 達哉^a, 西山 卓也^a, 芝内 孝禎^a, 松田 祐司^a, 寺嶋 孝仁^b ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : nakamura03@scphys.kyoto-u.ac.jp

重い電子系超伝導体であるCeCoInsはTe = 2.3Kで超伝導転移を示す.低温高磁場領域で は超伝導相内部に2次相転移が観測され,FFLO状態が実現している可能性が指摘されてい る.FFLO状態では,ゼーマン分裂したフェルミ面間でクーパー対が形成されるため,ク ーパー対が有限の重心運動量を持ち,実空間において周期的にノードが現れることが理論 的に指摘されている.このような特異な超伝導状態を持つ物質を理解する上で,その状態 密度を直接測定することは極めて重要である.

超伝導-常伝導体で作製されたトンネル接合の電流-電圧特性からは状態密度のエネルギー依存性を直接的に 測定でき,超伝導ギャップ構造やボゾン励起などの重要 な情報を得ることができる.我々は,10⁻⁷Pa程度の高真 空中でのCeCoIn5のエピタキシャル薄膜作製に成功して おり,微細加工技術を確立することで,様々な接合が可 能になると期待される.

今回我々は CeCoIn⁵ のエピタキシャル薄膜を加工し, 面内方向のトンネル接合を作製した. 図にその電流-電圧 特性を示す. 1.53K で 180µV 付近に超伝導ギャップを確 認できた. 当日は作製方法などについて発表する.

P8 Dynamic nuclear polarization and nuclear spin polarization control in shallow-doped Si:P

藤井裕¹, 光藤誠太郎¹, 水崎隆雄¹, 田中俊大¹, 菊池彦光², 上野智弘³, <u>松原明⁴</u>, 福田昭⁵, SangGap Lee⁶, Minchan Gwak⁶, Soonchil Lee⁷, Sergey Vasiliev⁸ ¹福井大学 遠赤外領域開発研究センター,²福井大学 工学部,³京都大 学 医学部,⁴京都大学 低温物資科学研究センター,⁵兵庫医科大学 物

理学教室, ⁶KBSI, ⁷KAIST, ⁸Turku 大学

E-mail : akira@ltm.kyoto-u.ac.jp

One of the best practical quantum computer designs reported so far is the system consisting of phosphorus atoms regularly spaced inside silicon crystal as proposed by B. Kane (Nature **393** (1998) 133). Experimental demonstration, however, has not been done yet. In this study, we are going to study ensemble of ³¹P nuclear spins in phosphorous-doped silicon (Si:P) instead of detecting a state of single ³¹P nuclear spin like in Kane's model. In Si:P, the donor electrons are well localized around the donor ions if the donor concentration is below the critical doping concentration, n_c , while they are delocalized above n_c . Then, the P atoms in shallow-doped Si:P are in the similar environment with those in Kane's model. We note that, however, ³¹P-NMR signal in shallow-doped Si:P has not been reported and detailed information including nuclear relaxation rates is almost unavailable at present. In order to observe ³¹P-NMR signal with a help of dynamic nuclear polarization (DNP), we have been developing ESR/NMR double resonance system. We report here spin dynamics observed by ESR experiments and ESR/NMR double resonance experiments.





0.4



P9 超流動ヘリウム 3 テクスチャーの MRI による可視化

<u>金本 真知</u>^a, 伊藤 良介^a, 人見 純司^a, 笠井 純^a, 佐々木 豊^{a,b} ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : kanemoto@scphys.kyoto-u.ac.jp

超流動³He は p 波スピン 3 重項の対凝縮体であり、その状態を表す秩序変数はいくつかの自由度を持つ. A 相の秩序変数は *l,d* という特徴的な 2 つのベクトルの向きによって表され、その空間分布をテクスチャーと呼ぶ. 秩序変数は基本的にその内部エネルギーを最小とするよう空間分布するが、場合によってはドメインウォールと呼ばれるトポロジカルな欠陥が発生する. 我々は MRI の手法を利用し、欠陥形成あるいは安定化のメカニズムについて研究したいと考えている. NMR では秩序変数の情報は観測される共鳴周波数のズレとして得られる. 通常の MRI では勾配磁場によって空間情報は周波数に置き換えて得ら

れる.そのため,通常の MRI では空間情報とテクスチャーの情報が混じってしまう.この問題を解決するため,我々は空間情報と周波数情報を分けて画像化する周波数分解 MRI を開発した.

周波数分解 MRI によって超伝導マグネットがつくる静磁場の 空間分布を測定したものが右の図 1 である.中央の白い部分が NMR コイルの測定領域で,直径は 6mm 程度である.黒色の濃 さが周波数を表しており,白いほど周波数が高い.周波数の分 解能は 57Hz である.周波数の分布は 350Hz 程度であり,磁場 勾配なしで得た信号のスペクトルとほぼ一致する.

P10 エアロジェル中液体ヘリウム3の熱輸送

<u>伊藤 良介</u>^a, 人見 純司^a, 笠井 純^a, 金本真知^a, Y. S. Lee^b, 佐々木 豊^{a, c} ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^bフロリダ大学

。京都大学低温物質科学研究センター

E-mail: ito.ryosuke@scphys.kyoto-u.ac.jp

エアロジェルは液体³Heに対して適度な不純物効果をもたらすことで知られている.不純 物効果の多くはエアロジェルの空間構造の特徴的長さが³He準粒子散乱の平均自由行程長の 上限となることによってもたらされる.このため,バルクの平均自由行程長が構造長を超え る低温ではエアロジェル-³He準粒子間の散乱が支配的となり,有効的な平均自由行程長が温 度に依存しなくなることがスピン拡散係数の測定で確認されている[1].スピンと熱の輸送 では準粒子の散乱振幅異方性の違いがあるので,同一ではないが同様の平均自由行程長に 依存する熱伝導率においても温度依存性の変化が期待される[2].



Fig. 1 20mK でのエアロジェル中 液体 ³He の温度分布

本実験では温度計としてエアロジェルの表面に生成する固体 ³He層を利用し,熱流の方向に印加した磁場勾配下のNMR信号を取 得する新規な手法によってエアロジェル中液体³Heの温度分布を 直接測定した.これによりエアロジェル中液体³Heの熱伝導率を 得ることができた(Fig.1).

[1] J. A. Sauls, Yu. M. Bunkov, E. Collin, H. Godfrin, and P. Sharma, Phys. Rev. B 65 024501 (2002)

[2] J. A. Sauls and P. Sharma , New Journal of Physics 12 083056(2010)



図1



P11 Investigation of superfluid ³He in networked confined geometry

<u>人見 純司</u>^a, 伊藤 良介^a, 笠井 純^a, 金本 真知^a, 佐々木 豊^{ab} ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : junji.hitomi@scphys.kyoto-u.ac.jp

私たちは細孔径が超流動³He のコヒーレンス長と同程度である多孔質物質中に閉じ込めた液体³He の超流動相について探索を行った.実験は細孔径が 100nm の多孔質物質を用いて行った.

初めに拡散係数測定により液体³He が存在している空間サイズを推定した(図 1).空間サイズを推定した(図 1).空間サイズは 260nm と推定され使用した細孔径と同程度であった.これにより液体³He は適切に充填されていることが確認できた.

超流動相の探索では NMR スペクトルの周波数 シフトを測定した.周波数シフトはクーパー対 の形成と密接にかかわっている.したがって周 波数シフトは超流動転移の指標となる.私たちは この測定においてバルクの転移温度より高い温度



図1:拡散係数と温度.これより細孔径は260nmと推定される.

で NMR スペクトルが超流動転移を示す周波数シフトを始める様子を観測した.これはサ イズ効果で期待される転移温度の低下とは真逆の結果であり非常に興味深いものである.

P12 エアロジェル中の³He⁻⁴He 混合液

<u>笠井 純^a</u>, 伊藤 良介^a, 人見 純司^a, 金本 真知^a,佐々木 豊^{a,b} ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : kasai.jun@scphys.kyoto-u.ac.jp

エアロジェルは、シリカの細い糸が絡まった空孔率の大きい物質である.このエアロジェル中に液体 ³He を導入すると、シリカの糸が不純物のように振る舞い、バルクの液体 ³He とは物理量が変化する.バルクの ³He-⁴He 混合液は極低温で ⁴He に少量の ³He が溶け

込んだ希薄混合相と,純粋な³He の相に分離してしまうことが知られている.しかしエアロジェル中では,mK領域で液体³He に少量の⁴He が溶け込んだ形の,濃厚混合液が存在する可能性が間接的な測定により指摘されていた.

我々はエアロジェル表面に固体 ³He が 生成されるのを防ぐために導入される ⁴He を,通常より過剰に導入した場合に, 観測されたスピン拡散係数の変化から, フェルミ液体理論のパラメータ F_0^a が変 化していることを発見した.この結果は エアロジェル中では濃厚混合液が存在し ている直接的な証拠ではないかと考えて いる.





P13 ドコサヘキサエン酸の乳がん細胞への作用

<u>佐藤 智</u>^a, 朴貞河^a,川本純^b,栗原達夫^b ^a京都大学 低温物質科学研究センター ^b京都大学 化学研究所 E-mail:sbsato@ltm.kyoto-u.ac.jp



長鎖多価不飽和脂肪酸(LPUFA=long chain polyunsaturated fatty acid)であるドコサへキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)は、がん細胞とがんに付随する血管内皮細胞による血管新生や炎症を制御する作用が注目されている. がん細胞は、細胞増殖の亢進とがん抑制機構の異常とが重なる複数の遺伝子の変異によって確立する. PUFA の作用は、前者に関連すると期待できる. ヒト乳がんの 10-15%を占める HER2-enriched type は、生体膜の信号伝達の異常が顕著である. 我々は、このタイプに属する MDA-MB-453 細胞株に対する PUFA の作用に着目した.

我々は、脂肪酸や様々な薬品で処理した MDA-MB-453 細胞を N₂ にストックし、タンパク質のリン酸化と脂質代謝を系統的に解析している. 我々は、細胞の増殖、糖代謝をポジティブに制御し、細胞周期の進行を 高め、細胞死の抑制するタンパク質である Akt のリン酸化異常を確認し、 DHA がこの異常を抑制することを見出した. Akt は何種類かのタンパク 質によってリン酸化されるが、我々の研究は DHA がこれらに共通して必 要な条件を阻害していることを示唆した. さらに、我々は GC-MS によっ て、DHA がリン脂質アラキドン酸プールを偏させることも見出した. アラキ ドン酸は Akt リン酸化を制御するホスホイノシチドを構成する脂肪酸であ り、従来からその異常が細胞がん化に関係する可能性が指摘されている. 我々は、DHA などの脂質作用から、がん細胞制御作用の解明を目指し ている.



P14 Eicosapentaenoinc acid attenuates surface expression of Annexin A2 in human umbilical vein endothelial cells

Jungha Park (朴貞河)², <u>佐藤 智</u>^{*}*, 川本純^b,栗原達夫^b ^a京都大学 低温物質科学研究センター ^b京都大学 化学研究所 *E-mail:sbsato@ltm.kyoto-u.ac.jp

Polyunsaturated Fatty Acids (PUFAs) such as EPA (eicosapentaenoic acid) are important molecules for the membrane functions. They can modify various physiological responses in inflammation, angiogenesis and blood circulation. One of its major targets is the endothelium, a thin cell layer that lines the interior surface of blood vessels. It forms an interface between the circulating blood/lymphatic cells and the rest of the vessel wall. Endothelial cells form endothelium and their dysfunction is an initial step in the atherosclerotic process, which often advances in diabetes. EPA has been proposed to control functions of proteins in the cells at transcriptional and posttranslational levels. We performed comprehensive analysis of proteins in human

umbilical vein endothelial cells (HUVECs) by MALDI-TOF mass spectroscopy. We found that EPA markedly affected the expression of annexin A2, which uniquely translocates from the cytoplasm to the cells surface during inflammation. EPA markedly attenuated this process. Our results suggested that EPA modulates the fibrinolysis, a post-thrombus process.





P15 (EDO-TTF)₂PF₆の光誘起相転移過程の時間分解構造解析

矢持 秀起

京都大学 低温物質科学研究センター E-mail:yamochi@kuchem.kyoto-u.ac.jp

パルス光照射によって固相の電子状態が変化する光誘起相転移(PIPT)は、光エレクトロ ニクスへの応用のみならず、動的過程を研究する物性科学の新分野の展開にとって重要な 現象である. その解析には 1 ps(10⁻¹² 秒)以下の時間分解能を持つ分光学的な方法が主に用 いられてきた. しかし、X-線回折法の時間分解能は 100 ps 程度であり、一般には PIPT の 初期過程の構造変化を検討する事は困難であった.

発表者らが開拓した標題物質は,280 K で金属-絶縁体転移 を起こす.この時,EDO-TTF 分子上の電荷の再配置と共に, 結晶内での分子の位置と形状の変化が起きる(図).この低温 相は高効率・超高速な PIPT を示す.分光学的な研究により, その初期過程で起きる分子間での電子移動やその後の緩和に ついての知見が得られていたが,構造については情報が無か

った.ごく最近,共同研究者によって約 0.4 ps の時間分解能を持つ電子線回折法が開発され,初期状態の構造が決定された[1].本発表では,この構造解析の結果を紹介する.

[1] M. Gao, C. Lu, H. Jean-Ruel, L.C. Liu, A. Marx, K. Onda, S. Koshihara, Y. Nakano, X.F. Shao, T. Hiramatsu, G. Saito, H. Yamochi, R.R. Cooney, G. Moriena, G. Sciaini, R.J.D. Miller, *Nature*, accepted for publication (2013).

P16 フラーレンアニオン層の構造と磁性

 大塚 晃弘^a, コナレフ デュミトリ^b, カザノフ サラバト^c, 石川 学^a, リュボブスカヤ リマ^b, 矢持 秀起^a, 齋藤 軍治^d
 ^a京都大学 低温物質科学研究センター,^bロシア科学アカデミー 化学物理研究所,^cロシア科学アカデミー 固体物理研究所,
 ^d名城大学 農学部

E-mail : otsuka@kuchem.kyoto-u.ac.jp

C₆₀ アニオンを使って様々なタイプのラジカル塩を作成することができる. C₆₀ アニオン ラジカル(C₆₀[•])が二次元の層を形成し,かつ,ダイマー化などでラジカルスピンが消失し てしまわない状況では,電気伝導性やスピン間相互作用の基底状態に興味が持たれる.

TMP カチオン(図 1), C_{60}^{--} , ベンゾニトリルから成る 1:1:1 のラジカル塩 (1)では, C_{60}^{--} が蜂の巣状に配置したアニオン層を形成し, 各 C_{60}^{--} は 3 種類

の異なる分子間重なり積分により,層内で隣接相互作用を及ぼし合っている(図 2).金属

はじっっている(因 2). 並属 伝導は示さないが、 C_{60} ・が 層内で比較的密に詰まって いるにもかからず 1.9 K ま でダイマー化せず、反強磁 性的相互作用を保持する珍 しい例である.



図 1. TMP (*N*, *N*, *N*'-trimethyl piperazinium) カチオン



図 2. 120 K の(1)層内にお ける C₆₀・配置





図 標題錯体中での EDO-TTF の電荷と充填様式(左; 室温相,右;低温相)

P17 δ型分子配列を有する有機導電体(ET)₂C(CN)₃の相転移

<u>中野義明</u>^a, 石川学^a, 吉田幸大^b, 西駿明^c, 前里光彦^c, 矢持秀起^a, 齋藤軍治^b, 売市幹大^d, 藥師久彌^e, Loïc Toupet^f, Eric Collet^f ^a京都大学 低温物質科学研究センター, ^b名城大学 農学部, ^c京都大学大学院 理学研究科 化学専攻, ^d分子科学研究所, ^e豊田理化学研究所, ^fレンヌ第一大学

E-mail : nakano@kuchem.kyoto-u.ac.jp

一般に有機導電体の金属状態は不安定で、電子-電子、電子-格子相互作用に由来する相転移やクロスオーバーを起こして絶縁 体状態となる.また一方で、このような不安定性に着目し、微弱

な外部刺激に対して迅速・巨大応答を示す物質の探索が行なわれている. 有機導電体 (ET)₂C(CN)₃は, ET 分子がδ型分子配列[1]をとり,約180 K で金属-絶縁体転移を起こし て,非磁性となる. この相転移はパイエルス不安定性によるものと報告されているが,低 温相の構造の詳細は明らかになっていなかった[2]. 本研究では,将来,本相転移を光によ り制御することを目的とし,その熱平衡状態を検討した. ラマン分光法により相転移温度 以下で ET 分子の C=C 伸縮モードの分裂が観測され,150 K において ET 分子は+0.75 価と +0.25 価の不均一な電荷を有していることが明らかになった. また,赤外分光法からも同様 の結果を得た. さらに低温相のフル構造解析にも成功し,低温相は,格子変調に加えて ET 分子の電荷が不均一になった電荷秩序状態であることが分かった.

T. Mori, Bull. Chem. Soc. Jpn. 72, 2011 (1999); [2] M. A. Beno et al., Inorg. Chem. 28, 150 (1989).

P18 新規 κ型 BEDT-TTF 塩の結晶構造ならびに電子物性

<u>吉田 幸大</u>^a, 伊東 裕^b, 前里 光彦^c, 平松 孝章^a, 齋藤 軍治^a ^a名城大学 農学部

^b名古屋大学 工学研究科 応用物理学専攻

°京都大学 理学研究科 化学専攻

E-mail : yyoshida@meijo-u.ac.jp

層状分子性固体 κ-(BEDT-TTF)₂X(図 1)は,高 T_c超伝導状態,スピン液体状態,リラク サー的な誘電異常など多くの興味深い性質を示す.BEDT-TTF ダイマー間移動積分の異方

性 t'/t (図 2 参照) はスピン揺らぎの指標であり基底状態とも密接に 関係するが、多くの κ -(BEDT-TTF)₂X は t'/t < 1 であり、t'/t > 1 をもつ 物質の開発ならびに物性研究はほぼ未知の領域である.本研究では、

四面体陰イオン $B(CN)_4$ ⁻を用いた電解酸化により新規 κ -(BEDT-TTF)₂ $B(CN)_4$ を得た. 10 K 級超伝導体 X = $Cu[N(CN)_2]Br$ と同じ空間群をもつが,室温伝導度 0.5 $S \text{ cm}^{-1}$ の半導体的挙動(活性化エネルギー0.15 eV) を示し, 1.8 GPa の静水圧下でも金属的挙動は観測さ れなかった. 拡張 Hückel 法から室温での t'/t (= t_{b2} / ($|t_p| + |t_q|$);図 2 左)は 1.42 と見積もられ(100 K では 1.61 まで増加), 1 次元鎖に近い歪んだスピン三角 格子(図 2 右)を形成していると予想される.

 G. Saito, Y. Yoshida, Bull. Chem. Soc. Jpn. 2007, 80, 1– 137.





図2 (左) κ -(BEDT-TTF)₂B(CN)₄の結晶 構造(赤点線楕円は BEDT-TTF ダイマ ーを表す),(右)ダイマーモデルに基 づいた模式図(黒丸は S = 1/2 BEDT-TTF ダイマーを表す)



ET

P19 逆ペロブスカイト型(TSF)₃[(Mo₆X₁₄)X](X=Cl,Br)錯体の 結晶構造と磁気秩序の相関

平松孝章 °, 吉田幸大 °, 大塚晃弘 b, 矢持秀起 b, 清水康弘 °, 服部祐磨 d 岸田英夫^d, 伊東裕^d, Kaplan Kirakci^e, Stéphane Cordier^e, Christiane Perrin^e, 齋藤軍治^a

^a 名城大農,^b 京大低物セ,^c 名大院理,^d 名大院工,^e レンヌ第一大 E-mail : htakaaki@meijo-u.ac.jp

 $(TTF)_{3}[(Mo_{6}X_{14})Y](X = Y = Cl; X = Br, Y = Cl, Br)[1]は、 ペロブスカ$ イト型酸化物において酸素が占める位置を+1 価のドナー分子 (TTF⁺) (S = 1/2) が占める逆ペロブスカイト構造(図 1) をとる. 各ドナー分子間の相互作用が同等であれば系全体としてスピンフラ ストレート状態を示すと期待されるが、実際には 6.3~8.2 K で反強 磁性転移を起こす.本研究では、各ドナー分子間の相互作用の相対 強度を変調し、同時に全体としてより強い分子間相互作用を持たせ るため、セレン誘導体である TSF を含む表題の錯体を作製した.

X 線構造解析から、これらの錯体は TTF 錯体と同形であること が確かめられた.また、TSF⁺のスピン(S=1/2)に由来する磁化率 は Curie-Weiss 的な温度変化を示した(Weiss 温度 は X = Cl で-1.6 K,



図 1. TTF ならびに TSF 分子(上)と逆ペ ロブスカイト型構造中 のドナー分子(橙)と ハライド(緑)の位置 関係 (下)

X = Br で-6.3 K). いずれの錯体も反強磁性転移を起こすが、転移温度は TTF 錯体に比べ て抑制されていた(X = Cl で 3.0 K, X = Br で 5.5 K). 当日は,分子間相互作用と磁気的挙 動の相関について議論する.

[1] P. Batail et al., Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 30 (1991) 1498.

(CLEDO-TTF)₂PF₆の相転移挙動と基底状態 P20

石川 学^a, 中野 義明^a, 賣市 幹大^b, 藥師 久彌^c, 矢持 秀起^a ^a京都大学 低温物質科学研究センター

^b自然科学研究機構分子科学研究所, ^c 豊田理化学研究所 E-mail : m-ishikawa@kuchem.kyoto-u.ac.jp

陽イオンラジカル塩(EDO-TTF)2PF6は、多重不安定性による金 属-絶縁体転移や高効率・超高速光誘起相転移を示す特異な物質 である.本研究ではこの物質に比較的サイズの小さい置換基と して塩素原子を導入し、標題の新規相転移物質を得た.

今回は、この物質の構造と物性の詳細を報告する. この物質の電子系の次元性は室温近傍では擬一次元 であるが、冷却に伴い約230 K で二次元へと徐々に 変化した.この次元性クロスオーバーに際し、ドナ ー分子によるダイマー間の相対位置が連続して約1 Å もの大きな変化を示した(図).磁化率測定の結 果,35 K 以下で非磁性となる磁気転移が観測された. しかし、スピン対形成に際して予測される結晶格子 の2倍化は10Kにおいても観測されなかった.こ れらの結果から,本物質の基底状態は長距離秩序を 持たないスピン一重項状態,即ち Valence Bond Solid であると考えられる.



 10.0×10^{-4}

mol⁻¹

emu

0.0

成分を差し引いてある

P21 混晶[(EDO)_{1-x}(CLEDO)_x]₂PF₆の相転移挙動における置換基効果

<u>原口知之</u>^a,石川学^b,中野義明^b,大塚晃弘^b,賣市幹大^c,矢持秀起^b

*京都大学 理学研究科 化学専攻

^b京都大学 低温物質科学研究センター

°分子科学研究所

E-mail : yokomitu@kuchem.kyoto-u.ac.jp

(EDO)₂PF₆は 279 K でパイエルス転移, 陰イオンの 秩序化,電荷秩序化(CO)の3種の機構が協同した特 異な金属―絶縁体転移を起こす.この錯体中のドナー を一部 MeEDO で置換した混晶[(EDO)1-x(MeEDO)x]2PF6 では, x ≧ 0.06 で転移機構の分離・抑制が見られた. 一方 で CLEDO は、塩素の強い電子吸引性によりそのドナー性 が EDO よりも有意に弱くなっている. そのため, CLEDO を用いた混晶ではその相転移機構,特に CO 転移の発現に 影響することが期待される.本研究では,EDO の一部を CLEDO で置換した標題の混晶を作製し、相転移挙動に対 する置換基効果について検討した. 4 K におけるラマン分 光測定(図 2)において, x = 0.18, 0.46 では, +0.5 価のド ナー分子由来の振動モードに加えて低波数シフトとブロー ドニングを伴った+1価と+0価の振動モードが共存しており、 電荷不均化が生じている.このような電荷不均化は同等の 組成比 x の[(EDO)_{1-x}(MeEDO)_x]₂PF₆では観測されておらず, 置換基の違いによる転移挙動の変化が明らかとなった.





図1 本発表で扱うドナー分子



Raman Shift/cm¹ 図 2 標題混晶のラマンスペク トル (励起波長 633 nm, 4 K) v_i ($i = \alpha, \beta, \gamma$)は EDO の C=C 伸 縮に帰属される振動モード (CLEDO についてもほぼ同じ 波数に観測されている)

P22 熱測定による Sr₂RuO₄の超電導一次相転移の発見

米澤 進吾, 梶川 知宏, 前野 悦輝

京都大学 理学研究科 物理学·宇宙物理学専攻 物理学第一分野

E-mail : yonezawa@scphys.kyoto-u.ac.jp

層状ルテニウム酸化物超伝導体 Sr₂RuO₄ は,平行スピンの電子対が超伝導を示すスピン 三重項超伝導体の最も有力な候補として盛んに研究されている.我々はこの物質の超伝導 状態が磁場によって壊されて常伝導状態に戻る際の相転移を,磁気熱量効果および比熱の 測定を通じて研究した.磁気熱量効果とは,磁場の変化に伴って試料の温度が変化する現 象で,エントロピーの磁場微分を求められる実験手法である.即ち,エントロピーの温度 微分を求められる比熱測定と相補的な研究手法である.これらの実験の結果,磁場が導電 面に平行な場合に,0.8 K 以下において潜熱や過冷却(過熱)現象を明確に観測した.こ れらの結果は,この相転移が,水が氷になる場合と同じような一次相転移になっているこ とを強く示している[1].

Sr₂RuO₄を始めとするほとんどの化合物超伝導体は第 II 種超伝導体であり、磁場中での 超伝導-常伝導転移は二次相転移であることが期待される.幾つかの例外は知られているが、 本研究で発見された一次相転移はこれらのメカニズムでは理解できない.従って、Sr₂RuO₄ の一次相転移は、Sr₂RuO₄の超伝導がこれまで見落とされていた未知の相互作用によって 壊されているということを強く示唆している.

[1] S. Yonezawa, T. Kajikawa, Y. Maeno, Phys. Rev. Lett. 110, 0 077003 (2013).

P23 Switching in Nb/Ru/Sr₂RuO₄ topological junctions

<u>M. S. Anwar</u>^a, Taketomo Nakamura^{a,b}, S. Yonezawa^a, M. Yakabe^c, R. Ishiguro^c, H. Takayanagi^c, and Y. Maeno^a ^a Dep. Phys. Kyoto Univ. ^b ISSP Univ. Tokyo ^c Dep. Appl. Phys. Tokyo Univ. Sci. Email: anwar@scphys.kyoto-u.ac.jp

Various experiments reveal that superconducting order parameter of Sr_2RuO_4 exhibits the spin-triplet chiral *p*-wave nature with broken time reversal symmetry [1]. Due to two-fold degeneracy of chirality originating from the direction of the Cooper pair angular momentum, chiral domain structure is expected to emerge in Sr_2RuO_4 . Chiral domains are separated by chiral domain walls. To investigate its topological aspects, originating from its orbital phase winding and chiral domain structure, we fabricated SNS' micron sized topological junctions consisting of niobium (as an S) eutectic crystals of Ru (as an N) metal inclusions imbedded in Sr_2RuO_4 (as an S') [2]. We report observations of unusual temperature dependence of the critical current I_c , anomalous hysteresis with current, and telegraphic noise in voltage. These reflect unusual switching between higher and lower I_c states. These phenomena are well reproduced with our calculations based on chiral domain wall motion, as shown in the figure [3,4].

[1] Y. Maeno, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, 011009 (2012).

[2] T. Nakamura, et al., PRB 84, 060512 (2011); JPSJ 81, 064708 (2012).

[3] A. Bouhon and M. Sigrist, New J. Phys. 12, 043031 (2010).

[4] M.S. Anwar et al., submitted (2013).

P24 元素置換によるスピン軌道相互作用の変化と超伝導

<u>江口 学</u>^a, D. C. Peets^a, M. Kriener^a, 包桂芝^b, 稲田佳彦^{bc}, 原田翔太^b, 鄭国慶^b, 前野悦輝^a

*京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野
 *岡山大学自然科学研究科, *岡山大学教育学研究科



E-mail : geguchi@scphys.kyoto-u.ac.jp

結晶の空間反転対称性の破れに起因して生じる反対称スピン軌道相互作用は,有効ゼーマン磁場として電子スピンに依存するエネルギー分裂をもたらすだけでなく,結晶の対称 性を反映した特異なスピン配列を引き起こす.この状況下での超伝導はスピン一重項-三重 項混合状態として表され,様々な新奇現象が起こる舞台として注目を浴びている[1].

超伝導体 Li₂(Pd_{1-x}Pt_x)₃B は, Pd-Pt 元素置換により反対称スピン軌道相互作用が急激に増 大し, x=0.9 以上でスピン三重項超伝導状態が支配的になることが知られている[2]. 今回

我々は、本物質における超伝導特性の変化と 密接に関係すると見られる常伝導状態の比熱 の異常を発見したので報告する.

- S. Fujimoto, J. Phys. Soc. Jpn. 76, 051008 (2007).
- [2] S. Harada *et al.*, Phys. Rev. B 86, 220502(R) (2012).



図 1 Li₂(Pd_{1-x}Pt_x)₃B 結晶における空間反転 対称性の破れ.



P25 新奇な強磁性量子臨界性を示す重い電子系 Ce(Ru_{1-x}Fe_x)PO

<u>北川俊作</u>^a,石田憲二^a,中村哲郎^b,的場正憲^b,神原陽一^b ^a京都大学 理学研究科 物理学宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b慶応大学

E-mail : shunsaku@scphys.kyoto-u.ac.jp



CeFePO, CeRuPO は鉄系超伝導体 LaFeAs($O_{1-x}F_x$)と同じ二次元性の高い結晶構造を持つ物質である. CeFePO は低温の残留比熱係数が 700 $mJ/molK^2$ と大きな値をもつ重い電子系

物質であり、ゼロ磁場中では常磁性体である. 一方、 CeRuPO は $T_{Curie} = 15$ K,近藤温度 $T_{K} \sim 10$ K の強磁性重い電子系物質である.

我々は静的磁化率を検出するナイトシフトと動的ゆらぎを 検出するスピン-格子緩和率 $1/T_1$ の測定を用いて重い電子系 $Ce(Ru_{1,x}Fe_x)PO$ の磁気状態について研究を行っている. 我々 はこれまでに $Ce(Ru_{1,x}Fe_x)PO$ において Fe 置換に伴い,磁気相 関の次元性が低下するとともに強磁性転移温度が減少し, $x \sim$ 0.86 で特異な強磁性量子臨界点を示すことを明らかにした (図1).当日は詳細な実験結果を示し,その新奇な量子臨 界性について議論する.

G,

P26 BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂における反強磁性量子臨界点近傍と 磁性-超伝導共存相の研究

<u>家 哲也</u>^a, 中井 祐介^a, 北川 俊作^a, 石田 憲二^a, 笠原 成^b,芝内 孝禎^a, 松田 祐司^a, 寺嶋 孝仁^b

^a京都大学 理学研究科 物理学宇宙物理学専攻 物理学第一分野

^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : tiye@scphys.kyoto-u.ac.jp

我々は鉄系超伝導体 BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂ における磁性と超伝導の関係について、核磁気共鳴 (NMR) 測定により調べている.昨年の結果として、BaFe₂As₂の As を P に置換していく

ことで、内部磁場(磁気秩序パラメータ)が連 続的に抑制され、 $x \sim 0.35$ で消失することを明 らかにした[1]. このことは $x \sim 0.35$ に磁気量子 臨界点が存在することを示している.また、興 味深いことに、磁性と超伝導の相境界に位置す る試料(x = 0.25, 0.27)で、超伝導転移ととも に内部磁場が抑制されることを明らかにした. 本発表では、本系における量子臨界点の役割と 秩序変数の共存/競合状態について議論する. また、共存/競合の性質から得られる超伝導の 電子対形成機構に関する知見について議論する.

[1] T. Iye et al., Phys. Rev. B 85 (2012) 184505



図 1. BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂の各 P 濃度における 内部磁場の温度依存性. 実線は秩序変数 の温度依存性を表す関数でフィッティン グしたもの.



P27 ルテニウム酸化物への一軸性圧力効果

<u>谷口晴香</u>^a, 西村佳悟^a, 中村壮智^b, S. K. Goh^c, 米澤進吾^a, 中村文彦^d, 前野悦輝^a ^a 京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野, ^b 東京大学 物性研究所, ^c Univ. of Cambridge, Cavendish Lab., ^d広島大学 先端物質科学研究科 量子物質科学専攻 E-mail: taniguchi@scphys.kyoto-u.ac.jp

スピン三重項超伝導体 Sr₂RuO₄やモット絶縁体 Ca₂RuO₄の基底状態は,結晶構造に対し敏 感に多彩な変化を示す.そのため意図的に結晶構造を制御しうる一軸性圧力を用いた研究 が電子状態の解明につながると期待できる.しかし,酸化物においては一軸性圧力実験の

技術は世界的に見て も確立途上である.

本発表では,我々 の開発した一軸性圧 力実験法について紹 介するとともに,そ の技術を用いて測定 した電気抵抗や磁化 の結果をもとにルテ ニウム酸化物の電子 状態について議論す る.



P28 UCoGeにおける強磁性縦揺らぎが誘起する超伝導

<u>服部泰佑</u>^a, 軽部皓介^a, 井原慶彦^a, 石田憲二^a, 多田靖啓^a, 藤本聡^a, 尾崎英祐^b, 出口和彦^b, 佐藤憲昭^b, 佐藤伊佐務^c ^a京都大学 理学研究科 物理学宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b名古屋大学 理学研究科 物質理学専攻(物理系), ^c東北大学 金属材料研究所



E-mail : t.hattori@scphys.kyoto-u.ac.jp

我々は磁石であると同時に超伝導にもなる物質 UCoGe を核磁気共鳴法により研究して いる.まず,通常相反するはずの磁石と超伝導が互いに分離しているのではなく,混ざり

合った新しい量子状態として共存していることを 明らかにした.加えて,この特殊な超伝導の発現 メカニズムは磁石になろうとする性質(磁気揺ら ぎ)そのものであることを突き止めた.磁気揺ら ぎと超伝導の関係性については長きに渡り多くの 議論がなされていたが,明確な実験的証拠を初め て打ち出した本研究は,今後の超伝導メカニズム の研究において重要な意味を持つと思われる.加 えて,本来相反する磁石と融和したこの新奇超伝 導は外部磁場に非常に強い性質を持っており,実 用的な観点からも今後の発展が期待される.



P29 UCoAlのメタ磁性臨界現象のユニバーサリティ

<u>軽部 皓介</u>^a, 服部 泰佑^a, 石田 憲二^a, 小松原武美^c, 木村憲彰 ^{b,c} ^a京都大学 理学研究科 物理学宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b東北大学 理学研究科,^c東北大学 極低温センター

E-mail : karube @scphys.kyoto-u.ac.jp

UCoAlは, c 軸方向に1 T 程度の磁場を掛けることによって,磁

化に不運続な跳びか見られるメダ磁性転移を 転移であるが,約12Kで1次相転移線は臨 界終点を持ち,臨界終点より高温では常磁 性と強磁性が連続的に繋がる領域になる.こ の振る舞いは気体-液体転移と非常によく似 ている.

本研究では UCoAl のメタ磁性転移におけ る臨界現象の静的,動的性質を定量的に調 べるために,UCoAl 単結晶を用いて²⁷Al 核 の NMR を行った. *c*軸方向の磁場と温度を 制御しながら,*c*軸方向の磁気ゆらぎを見 積もると,図のように,磁気ゆらぎが臨界 終点で発散する結果を得た.また,臨界指 数から UCoAl のメタ磁性臨界現象が,気 体-液体転移と同様の3次元イジングユニバ ーサリティに属することを見出した.



図: UCoAl のメタ磁性転移の c 軸磁場-温度相図と c 軸磁気ゆらぎの分布

P30 Guest ion dependence of rattling in $A_xV_2Al_{20}$ (A = Ga, Al, La); measurement of the rattling frequency

<u>山中 隆義</u>^a, 北川 俊作^a, 石田 憲二^a, 小野坂 篤^b, 岡本 佳比古^b, 山浦 淳一^b, 廣井 善二^b

^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野, ^b東大物性研



E-mail : t-yamanaka@scphys.kyoto-u.ac.jp

ラットリングは局所的な非調和振動に特徴づけられるイオンや原子の巨大振動で、様々 な物性に影響を与えると考えられており、いくつかのカゴ状構造を持つ超伝導体では超伝 導との関連が指摘されている[1].しかしラットリングと超伝導の関係の詳細は解明されて おらず、両者の関係を理解するため、ラットリングの特性を理解することは重要である.

 A_x V₂Al₂₀ (A = Ga, Al, Y, La)は空間群 Fd-3m に属し, 16 個の Al 原子からなるカゴに $A \land T$ ンが内包された構造を持つ.小さな Ga, Al が $A \land T$ オンの場合は低温域の一部で電気抵抗・比熱の増大が見られ、ラットリングを示唆する低エネルギー励起が報告されている[2].

我々は $A_xV_2Al_{20}$ におけるラットリングの動的な性質を調べるために様々な A_x について NMR/NQR 測定を行った. その結果 Ga の系でのみ核スピン-格子緩和率($1/T_1$)に異常な温度 依存性があることを発見した. さらにこの $1/T_1$ の異常がラットリングに由来するものと考 え,分子運動に基づくモデルで解析した. その結果 Ga_{0.5}V₂Al₂₀ におけるラットリングのダ イナミクスは MHz 帯の低周波なものであることを見出した.

[1] J. Yamaura et al., J. Solid State Chem. 179, 336 (2006).

[2] A. Onosaka, et al., JPSJ. 81, 023703 (2012).

P31 NMR による Ba(Fe_{1-y}M_y)₂(As_{1-x}P_x)₂(M = Zn, Mn)の不純物効果の研究

<u>川島裕貴</u>^a,下田愛子^a,家哲也^a,北川俊作^a,石田憲二^a,笠原成^a, 芝内孝禎^a,松田祐司^a,寺嶋孝仁^b ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : kawashima@scphys.kyoto-u.ac.jp

鉄系超伝導体 BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂は、As を等価数の P に置換することで反強磁性転移温度 T_N が抑制され、最高の超伝導転移温度 $T_c^{max} \sim 30$ K ($x \sim 0.35$)を示す超伝導相が現れる.このように鉄系超伝導体は磁性相と超伝導相が隣接することから、磁性と超伝導の関係性が注目され、超伝導の発現機構について盛んに研究が行われている.

我々は BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂ について ³¹P 核の NMR を用いて微視 的に調べている[1, 2]. 今回我々は BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂の不純物置換 効果について調べた. Fe サイトに非磁性不純物の Zn, 磁性不 純物の Mn をドープした試料を作製し, NMR 測定を行った. 図 1 のように, Zn が T_c をほとんど抑制しない一方, Mn は T_c を強く抑制することから, 2 つの不純物の役割が違うことが示 唆される.本講演では, 不純物による磁気励起や超伝導特性の 変化について, NMR 測定を通して調べた結果を報告する.





図1 T_cの不純物濃度依存性.

[1] Y. Nakai et al., Phys. Rev. Lett. 105, 107003 (2010).

[2] T. Iye et al., Phys. Rev. B 85, 184505 (2012).

P32 人工超格子CeCoIn₅/YbCoIn₅における上部臨界磁場の異常性

<u>下澤雅明</u>¹, Swee. K. Goh^{1,2}, 水上雄太¹, 宍戸寛明^{1,*}, 渡邊大樹¹, 安元智司¹, 山下 穣^{1,†}, 寺嶋孝仁³, 柳瀬陽一⁴, 芝内孝禎¹, A. I. Buzdin⁵, 松田祐司¹ ¹京大院理, ²Cavendish Laboratory, University of Cambridge, ³京大低温セ, ⁴新潟大学, ⁵Université Bordeaux I, LOMA

Present address:^{*}阪府大工,[†]理研 E-mail: shimo@scphys.kyoto-u.ac.jp

これまでに数多くの重い電子系化合物の研究が行われてきたが、その全ては基本的には 3次元的な特性を示す事が知られている.しかしながらここ最近になって、分子線エピタ キシー法を用いて重い電子系化合物と通常金属を交互に積層した人工超格子を作製するこ とで、2次元重い電子系物質を作製することが可能になった.このような重い電子系化合 物による超格子構造では、その大きなスピン軌道相互作用とそれぞれの物質の界面での空 間反転対称性の破れに基づき、新奇物性が現れる可能性が理論面で指摘されているが、そ の実験例はほとんどない.

そこで本研究では,作製した人工超格子 CeCoIn₅(*n*)/YbCoIn₅(5)の上部臨界磁場の角度依存性($H_{c2}(\theta)$)を測定し,CeCoIn₅の層数(*n*)に対する $H_{c2}(\theta)$ の振る舞いの変化を評価することで,空間反転対称性の破れの重要性を示した.

n=3の超格子において、低温では印加した磁場の角度(θ)に対して $H_{c2}(\theta)$ が滑らかに変化 することから、この温度領域では上部臨界磁場がパウリ効果によって決まっていることが 分かる. 超伝導転移温度近傍では、超格子の面内方向付近 ($\theta \sim 0$)で $H_{c2}(\theta)$ にカスプが現れ るが、このカスプは n = 4,5の超格子では消失する. このことは、n = 3の超格子では局所 的な空間反転対称性の破れの度合いが相対的に大きくなることでパウリ効果による上部臨 界磁場が抑制され、軌道効果による上部臨界磁場が支配的に働くことを示唆している.

P33 重い電子系超伝導体 URu₂Si₂ の隠れた秩序相における 放射光測定による研究

<u>利根川 翔</u>^a, 笠原 成^a, 鶴原 悠悟^a, 水上 雄太^a, 渡邊 大樹^a, 福田 竜生^b, 杉本 邦久^c, 芳賀 芳範^d, 松田 達磨^d, 山本 悦嗣^d, 大貫 惇睦^{d,e}, 松田 祐司^a, 芝内 孝禎^a

^a京大院理,^b原子力機構放射光,^cJASRI,^d原子力開発機構,

°阪大院理

E-mail : tonegawa@scphys.kyoto-u.ac.jp

重い電子系超伝導体URu2Si2 はTh =17.5 K で大きな比熱の異常を伴う二次相転移を示す が、未だに秩序変数が明らかではないことから「隠れた秩序相」と呼ばれている.この隠 れた秩序相の秩序変数を調べるにあたって重要であるのが、何の対称性が破れているのか を知ることである.最近、磁気トルクとサイクロトロン共鳴実験により、結晶に保たれて いる四回回転対称性の破れが発見された.これにより、波数空間における回転対称性の破 れは明らかとなったが、実空間における破れはこれまで報告されていなかった.

そこで我々はspring8においてURu₂Si₂超純良単結晶を用いて隠れた秩序相における放射光 測定を行った.20スキャンの結果によると(880)の回折ピークが17.5Kから低温にかけて二 つに分裂していく様子が観察された.これは隠れた秩序相において非常に小さな構造相転 移(~100fm)が発現していることを示している.これは磁気トルクとサイクロトロン共鳴実 験を支持する結果であり,隠れた秩序相で回転対称性が破れていることを示している.

P34 電子線照射により不純物散乱を制御した鉄系超伝導体 BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂における超伝導ギャップ構造の変化

<u>水上 雄太</u>ª, 川本 雄太ª, 橋本 顕一郎ª,笠原 成ª,松田 祐司ª, 芝内 孝禎ª

^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 E-mail:mizukami@scphys.kyoto-u.ac.jp

鉄系超伝導体の発見以後, その超伝導発現機構と密接に関係する超伝導ギャップ対称性の研究が精力的に行われている.鉄系超伝導体 BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂ は, これまでに磁場侵入長, 熱伝導率, 核磁気共鳴測定からその超伝導ギャップにラインノードを持つことが明らかになっている.このノードが偶発的なノードであるのか対称性によって要請されたノードであるのか調べることは鉄系超伝導体の超伝導ギャップ対称性を決定する上で重要である.

我々は鉄系超伝導体BaFe₂(As_{1-x}P_x)₂のx=0.33, 0.36において,電子線照射により点欠陥を導入し不純物散乱の超伝導ギャップに及ぼす影響を調べた.ここで超伝導ギャップは不純物散乱により平均化される.従ってノードが偶発的ならばノードは不純物散乱により消滅し,超伝導ギャップ構造はフルギャップとなることが理論的に指摘されている[1].これらの試料において,不純物散乱の増大に伴う超伝導ギャップ構造の変化を調べるために準粒子の低エネルギー励起を直接観測可能な磁場侵入長測定を500mKの極低温まで行った.

その結果、両組成において不純物散乱の増大に伴い磁場侵入長は低温で一定となる熱活 性型の温度依存性を示した.これはこの系において存在していたノードが偶発的なもので あることを示すものである.本発表ではこの結果から考えられる超伝導対称性について議 論したい.

[1]V. Mishra et al., Phys. Rev. B 79, 094512 (2009).

50

P35 量子スピン液体の磁気励起の研究

<u>渡邊大樹</u>^a, 千秋義紀^a, 山下穰^{ab}, 利根川翔^a, 大島勇吾^b, 山本浩史^{bc}, 加藤礼三^b, I. Sheikin^d, K. Behnia^e, 寺嶋太一^f, 宇治進也^f, 芝内孝禎^a, 松田祐司^a

^a京大院理,^b理研,^c分子研,^dGrenoble High Magnetic Field Laboratory, ^eEcole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, ^fNIMS E-mail:d.watanabe829@scphys.kyoto-u.ac.jp

有機モット絶縁体 EtMe₃Sb[Pd(dmit)₂]₂はスピン 1/2 をもつ Pd(dmit)₂二量体が 2 次元反強 磁性三角格子をなす結晶構造をもつ. この物質は 250 K 程度の大きな交換相互作用 J をも つにもかかわらず, 10 mK の極低温においても磁気的秩序を示さない量子スピン液体であ ることがいくつかの実験によって示されている. この系の基底状態の性質を明らかにする 上で低エネルギー励起の性質を知ることは極めて重要である. これまでの極低温熱伝導率 測定からこのスピン液体状態はギャップレス励起があることが明らかになっているが, こ の励起が磁気的($S \ge 1/2$)か, 非磁気的(S = 0)かについては明らかではなかった.

そこで、低エネルギー励起の磁気的性質に敏感な物理量である極低温での磁化率を求め るために、不純物スピンに影響を受けにくい磁気トルクを EtMe₃Sb[Pd(dmit)₂]₂ とその重水 素置換体について極低温(30 mK),超強磁場(32 T)まで測定した.その結果、どちらの試 料でも絶対零度極限でスピン磁化率が有限に残ることを見出した.このことはギャップレ ス励起が磁気的な励起を含んでいることを直接的に示している.また、これらの結果はギ ャップレススピン液体が相図において量子臨界点ではなく、有限の広さを持つ安定な相と して存在することを示唆しており、モット絶縁体中の新奇量子相の存在を示唆している.

P36 純良試料 URu₂Si₂ の隠れた秩序相における

Giant Nernst Effect

<u>山下 卓也</u>^a, 利根川 翔^a, 鶴原 悠悟^a,芳賀 芳範^b,松田 達磨^b, 山本 悦嗣^b,大貫 惇睦^{b,c},芝内 孝禎^a,松田 祐司^a ^a京大院理,^b原子力開発機構,^c阪大院理

E-mail:t.yamashita@scphys.kyoto-u.ac.jp

1985年、重い電子系化合物 URu₂Si₂において、隠れた秩序相転移温度 $T_{HO} = 17.5$ K で大きな比熱の飛びを伴う二次相転移が観測された。17.5 K の相転移については未だその秩序変数について明確な結論は得られておらず、4 半世紀が過ぎた現在も「隠れた秩序相」として理論・実験の両面から様々な研究が行われている。近年、この隠れた秩序相において、ネルンスト係数が増大することが Bel らの研究グループによって報告されている。

ネルンスト係数の増大は渦糸の運動,銅酸化物高温超伝導体の超伝導転移温度以上における超 伝導揺らぎによる効果に加えて,最近では超伝導揺らぎがない領域でのSDW秩序相,ストライプ 秩序相,多極子秩序相,磁場誘起の量子臨界点近傍などにおいて確認されている.これらより, ネルンスト係数の測定が固体中の電子状態の変化を捉える上で非常に敏感な手法の1つであると 考えられる.

今回我々は、日本原子力研究開発機構で作製された、先行研究と比べて RRR が桁違いに大き な値をもつ純良な単結晶を用いて、隠れた秩序相におけるネルンスト効果を 7T までの磁場範囲 で測定した.その結果、ネルンスト係数は先行研究と同様に T_{HO} から増大しはじめたが、低温 領域での値は先行研究より約 10 倍に増加した.これは、隠れた秩序相においてキャリア密度が 激減していることに加え、純良試料で平均自由時間が長くなったためであると考えられる.

本講演では上記のネルンスト係数に加えて、ゼーベック係数、電気抵抗率、ホール係数について も合わせて報告する予定である.

P37 BaFe₂As₂薄膜の輸送係数測定

<u>綿重達哉</u>, 笠原成^a, 寺嶋孝仁^b, 芝内孝禎^a, 松田祐司^a ^a京都大学 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第一分野 ^b京都大学 低温物質科学研究センター

E-mail : t.watakko@scphys.kyoto-u.ac.jp

近年,鉄系超伝導体 Ba-122 系の研究が非常に盛んに行われている.その母物質である BaFe₂As₂ は, $T_N = 135K$ で反強磁性・構造相転移を起こし電気抵抗に折れ曲がりが現れる. ところが最近,これよりもさらに高温側の $T * \sim 170K$ でトルク測定によりネマティック 転移が確認された[1].また ARPES の測定により T *以下で擬ギャップ的な状態密度の減少 が確認されている[2].

今回我々は、母物質である BaFe₂As₂ において PLD 法を用い、10nm 程度の超薄膜から 300nm 程度の薄膜まで厚みを様々に変えて作製した.作製した薄膜の電気抵抗の温度依存 性を測定したところ、膜厚が 10nm 程度の超薄膜においてもバルクの試料で見られる $T_N = 135K$ での反強磁性・構造相転移を確認することができた.ただこれらの薄膜の場合、 T_N よりも非常に高温の $T \sim 175K$ 程度から電気抵抗が徐々に落ち始めるような振る舞いが見 られ、これはネマティック転移温度 T * に近い.また、厚みが 100nm 程度の薄膜で輸送係 数の測定も行ったが、過去に行われたバルクの BaFe₂As₂ の輸送係数測定の結果[3]とは、特に $T_N < T < T *$ の領域で異なるものとなった.

本講演では, BaFe₂As₂ 薄膜の輸送係数測定の実験結果の詳細を報告し,この異常な振る 舞いについて議論する予定である.

[1] S. Kasahara et.al., Nature 486, 382 (2012).

[2] 園部竜也 他 日本物理学会 2012 年秋季大会 20aGA-6

[3] S. Ishida et al., Phys. Rev. B 84, 184514 (2011).

P38 一次元フラストレート磁性体 LiCuVO₄における 異方的なスピンのゆらぎ

<u>那波 和宏</u>, 吉村 一良, 吉田 誠^a, 瀧川 仁^a, Steffen Krämer^b, Claude Berthier^b, Mladen Horvatić^b 京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 ^a東京大学 物性研究所 ^bCNRS グルノーブル強磁場研究所

Email : knawa@kuchem.kyoto-u.ac.jp

z 強磁性的な最近接相互作用と反強磁性的な次近接相互作用が競合する S = 1/2 の一次元 フラストレート磁性体ではネマティック状態など特異なゆらぎを示す状態が実現すると予

測されている[1,2]. 本研究では候補物質 LiCuVO₄ に関して NMR の測定を行い,スピンのゆらぎの磁場変化を研究した.

図に 4 - 34 T の磁場中における ⁵¹V 核の核磁気緩和率 1/ T_1 の 温度変化を示す.核スピン周りの対称性に関する議論から、 ⁵¹V 核の 1/ T_1 (*H*//*a*) では磁場に垂直なゆらぎ< $S_i^x S_j^x$ >のみを選 択的に観測することができると分かる. T_N 近傍で 1/ T_1 の強い 増強が観測される 4 T では垂直なゆらぎが強く発達し, T_N 近 傍で 1/ T_1 が熱活性型の振る舞いを示す 10 - 34 T では垂直なゆ らぎにエネルギーギャップが開くことが明らかとなった. 観 測されたゆらぎの磁場変化は理論的予測と合致しており,マ グノンが束縛対を形成していることが示唆された.

[1] T. Hikihara, et al., PRB, 78 (2008) 144404.

[2] M. Sato., et al., PRB, 79 (2009) 060406.

P39 混合原子価鉄酸化物 NaFe₂O₃の相転移

<u>小林 慎太郎</u>, 道岡 千城, 植田 浩明, 吉村 一良 京都大学 理学研究科 化学専攻 E-mail:s.kobayashi@kuchem.kyoto-u.ac.jp

電荷の自由度をもつ混合原子価の化合物には、電荷秩序をともなう 相転移を示すものが多く、盛んに研究が行われている.特に、遷移金属イオンが三角格子 などの幾何学的にフラストレートした格子を形成しているときには、電荷のフラストレー

ションの効果も加わり,新奇な基底状態が期待できる. このような観点から,我々はβ-NaFe₂O₃に着目した.この化合物は層状岩塩型構造を有 しており,NaとFeのつくるそれぞれの三角格子が,1:2の割合で,岩塩型構造の[111]方向

に規則的に積層している(図1). ここで, Feは1サイトであり,形式価数が2.5価であるため, 電荷のフラストレーションを有している.本物質について合成の報告はあるが[1,2],物性 は明らかになっていない.

そこで本研究では純良な多結晶試料を合成し,物性測定を行った.磁化率には,260 K及び230 K付近に異常を観測した.特に260 K付近では,熱量の授受がみられ,それに伴い構造も変化することが明らかとなった.さらに,この相転移温度で,電気抵抗率が30 倍以上増大する.従って,この相転移は電荷秩序の形成に由来するものだと考えられる.

当日はこの化合物の物性を詳細に報告し、それらの結果からこ の化合物の電荷秩序の可能性について議論する予定である.

[1] A. M. El Balkhi, *et al.*, J. Solid State Chem. **18**, 293 (1976).
 [2] R. Shaun, *et al.*, J. Solid State Chem. **192**, 68 (2012).

P40 遍歴電子メタ磁性体 SrCo₂P₂の NMR 測定

<u>今井</u>正樹^a, 道岡 千城^a, 植田 浩明^a, 太田 寬人^b, 吉村 一良^a ^a京都大学 理学研究科 化学専攻, ^b東京農工大学 工学部 E-mail: m.imai@kuchem.kyoto-u.ac.jp

ThCr₂Si₂型構造の $ACo_2P_2(A = alkaline earth, rare earth metal)は Co₂P₂$ 層と <math>A 層が交互に積層した層状化合物である(図 1). いずれも Co が 磁気モーメントをもつ遍歴電子磁性体であり, A = La では強磁性体, A = Ca, Ce は反強磁性体である[1]. SrCo₂P₂は強磁性に近い金属であ り,磁気秩序を示さないが磁化率が Curie-Weiss 則に従う温度変化を 示す. さらに SrCo₂P₂は高磁場を印加することにより常磁性相から強 磁性相に転移するメタ磁性転移を示す.

今回我々は SrCo₂P₂において³¹P 核の核磁気共鳴(NMR)を行った. NMR 測定では NMR スペクトルを通して原子核周りの電子や格子の 静的な性質および,核スピン-格子緩和率 1/*T*₁を通して電子の動的な 性質の情報が得られる.測定の結果,強磁性スピンゆらぎが支配的 な物質である事が明らかになった.ポスター発表では NMR 測定の 解析結果とスピンゆらぎの詳細について報告する.

[1] M. Reehuis, W. Jeitschko, J. Phys. Chem. Solids 51, 961 (1990).

図 1. NaFe₂O₃の結晶構造.

図 1 ACo₂P₂の結晶構造

P41 軌道の自由度を有するダブルペロブスカイト $A_2BMF_6(M = Ti, V)の構造相転移$

後藤 真人, 道岡 千城, 植田 浩明, 吉村 一良 京都大学 理学研究科 化学専攻 金相学研究室 E-mail : goto@kuchem.kyoto-u.ac.jp

ダブルペロブスカイト弗化物 $A_2BMF_6(A=Cs,Rb,K, B=Rb,K,Na, A \neq B, M=3d \text{ metal})$ (図 1) は、磁性イオンである M³⁺が面心立方格子を形成しており、スピンフラストレーションの 存在が期待できる.一般に A>BMF6 は室温では立方晶であるが,一部の化合物は低温で構 造相転移を示す.構造相転移の有無には、A,B,Mに入る元素のイオン半径の違いによって 定まる格子の不安定性が深く関係していると考えられている[1]. 前回の交流会では、軌道 の自由度を有する M = Ti の系について報告した[2]. Ti 系の全ての物質は、ワイス温度が

-40K 程度であるが 2K においても磁気秩序を示さず, そのいくつか では構造相転移が確認された.新たに合成した V系の全ての物質はワ イス温度が-70K 程度であり、低温で軌道が関与した特異な磁気秩序 が見られた. また Rb₂KVF₆では構造相転移がある.

ところが、Ti 系と V 系では構造相転移の有無や低温の構造の詳細 が異なっており、イオン半径から定まる格子の不安定性のみでは説明 できない.また,Ti系では構造相転移の前後で磁化率が大きく変化し

ている.この結果はスピンと軌道の自由度が構造相転移に対して重要 であることを示している. そこで Ti³⁺(d¹)と V³⁺(d²)の系の構造相転移における軌道の役割 を明らかにするため,軌道の自由度をもたない Cr³⁺(d³)の系も合成して,比較を行った.当 日は、物性の詳細を示すとともに、スピンと軌道の自由度の観点から構造相転移とそれに 伴う磁性の変化の関係について議論する予定である.

[1] I.N. Flerov et al. Journal of Fluorine Chemistry, 116 (2002) 9-14 .

[2] 後藤真人 他, 第10回 LTM 講演会·研究交流会(2012)

P42 パイロクロア型化合物 Cd₂Re₂O₆(O,F)'の物性

原口祐哉, 道岡千城, 植田浩明, 吉村一良 京都大学 理学研究科 化学専攻 E-mail : chiyuya@kuchem.kyoto-u.ac.jp

パイロクロア酸化物 Cd₂Re₂O₇はパイロクロア型の化合物としては初めて発見された超伝 導物質である.フラストレーションが寄与した特異な構造相転移を示すことが知られてい る.パイロクロア格子の持つフラストレーションの効果が、超伝導などの遍歴電子物性に どのような影響を及ぼすかを明らかにするため、Cd₃Re₂O_{7,x}F_x (x=0.05, 0.1, 0.3, 0.5)の合成

を試み、純良な試料を得ることに成功した. これらの試 料において帯磁率, 電気抵抗, ゼーベック係数, 低温 X 線回折測定をおこなったところ, T_{s2}が F ドープ量 x に対 して系統的に変化することがわかった.また、これらす べての試料において超伝導転移が観測され、比較的顕著 な不純物効果を示した.講演データでは、この系におけ るフラストレーション効果と電子状態の変化との関連性 について詳細な議論を加える.

[1] H. Sakai et al.: J. Phys.: Condens. Matter 13, L785 (2001). [2] M.Hanawa et al.: Phys.Rev.Lett. 87, 187001 (2001).

図1 A₂BMF₆の結晶構造

P43 Ca₃Ir₄Sn₁₃とその周辺物質の合成と物性

<u>松元 卓也</u>, 道岡 千城, 植田 浩明, 吉村 一良, 楊 金虎^A, 陳 斌^A, Lina E. Klintberg^B, Swee K. Goh^B, F. Malte Grosche^B 京都大学 理学研究科 化学専攻, 杭州教育大学^A, ケンブリッジ大学^B E-mail: matsutaku@kuchem.kyoto-u.ac.jp

 $Ca_3Ir_4Sn_{13}$ の結晶構造は $Pr_3Rh_4Sn_{13}$ 系に分類される,図1に示すような空間群**Pm3n**の籠 状物質で,転移温度 $T_c = 5$ Kのs波,強結合超伝導体である[1,2].また,この物質の常伝導 状態に対して,40 K 付近で磁化率及び電気抵抗率に異常が見出だされ[3],この異常は構造 相転移によるものであることが明らかになった[4].

 $Ca_3Ir_4Sn_{13}$ は電気抵抗率の温度変化において、低温部で $\rho - \rho_0 = A^*T^*(n=2)$ から外れ、 n=1 に近づくような、非フェルミ流体的な挙動を示す. 我々は、これと超伝導との関係を調 べるために、周辺物質における非フェルミ流体的挙動の有無と、超伝導転移温度、及び構造 について研究を行った.

この物質系は多様な物質群をもつ. 今回, 化学的圧力をかけるために, Ca₃Rh₄Sn₁₃, Sr₃Rh₄Sn₁3 を, また, 電荷ドープの影響を調べるために, La₃Rh₄Sn₁3, La₃Co₄Sn₁3 について合成及び物性測定をおこなった結果, 超伝導転移温度に対し構造の不安定性が重要な役割を持つことが明らかになった.

[1] J. P. Remeika et al., Solid State Commun. 34, 923 (1980).

[2] H. Hayamizu et al., Physica C. 470, 541 (2010).

[3] J.Yang et al., J. Phys Soc. Jpn. 79, 113705 (2010).

[4] L. E. Klintberg et al., Phys. Rev. Lett 109, 237008 (2012).

P44 Cu(110)表面における NO 分子間共有結合の直接観察

<u>塩足 亮隼</u>, 三井 拓也, 奥山 弘, 八田 振一郎, 有賀 哲也 京都大学大学院 理学研究科 化学専攻 E-mail:shiotari@kuchem.kyoto-u.ac.jp

一酸化窒素 (NO) は、2π* 軌道に不対電子を有する分子であり、金属表面上における NO の物性や反応は、その不対電子の振る舞いに大きく依存する.本研究では Cu(110) 表 面に吸着させた NO について、超高真空・低温における走査トンネル顕微鏡 (STM) およ び走査トンネル分光 (STS) 測定によって、その吸着構造と電子状態を単分子レベルで調べ た.

~40 K 以下の温度で吸着した NO は, 表面に直立した upright 構造となり, その $2\pi^*$ 軌道は分子に局在する.一方,~40 K 以上では,基板と強く相互作用した lying-down 構造となり, $2\pi^*$ 軌道は表面 準位との混成により非局在化する. STM/STS は,これらの吸着構造・電子状 態の違いを明確に反映している (図1). さらに,STM による吸着構造変化の頻度 測定によって,2 種類の吸着構造間のポ テンシャル図を提唱した.

(b) upright NO の STM 像 (2.0 nm×1.1 nm) および, (c, d) それらの吸着構造の模式図.

P45 金属吸着 Ge(111)表面の電気伝導度測定

野間 俊^a, 八田 振一郎^{a,b}, 奥山 弘^a, 有賀 哲也^{a,b} ^a京都大学 理学研究科 化学専攻

^bJST CREST

E-mail : noma.t@kuchem.kyoto-u.ac.jp3

近年、半導体表面上の金属単原子層が超伝導を示すことなどからその電気伝導度について関心が高まっている. 我々のグループで開発した表面敏感な直流 4 端子法による電気伝導度測定を 8.5 – 350 K の温度範囲において行った. 試料として Bi/Ge(111)-($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$)R30° および Pb/Ge(111)- β ($\sqrt{3} \times \sqrt{3}$)R30°を用いた. 角度分解光電子分光(ARPES)により、前者は金属的な表面状態を持たない[1]が、後者は金属的な表面状態を持つ[2]と報告されている. 今回の測定の結果、前者の電気抵抗率の温度依存性が半導体的であった. すなわち、電気抵抗率は(1)70 K 以下では単調に減少し、(2)70 – 250 K ではほとんど変化せず、(3)250 K 以上では単調に減少した. これらはそれぞれ(1)不純物領域、(2)飽和領域、(3)真性領域における振る舞いに対応していると考えられる. 一方、後者の電気抵抗率の温度依存性が金属的であり、電気抵抗率が温度に対しほぼ線形に増加した. 8.5 K における電気伝導度は約10 mS/square であった. さらに、この金属的な Pb/Ge(111)表面において、不純物の吸着により電気抵抗率が増加することを確認した.

- [1] S Hatta et al., 2009 Phys. Rev. B 80, 113309.
- [2] K Yaji et al., 2010 Nat. Commun. 1, 17.

P46 Cu(110)表面におけるフェノール単分子による伝導の観測

<u>羽深 智</u>,北口 雄也,八田 振一郎,奥山 弘,有賀 哲也 京都大学 理学研究科 化学専攻 E-mail:habuka@kuchem.kyoto-u.ac.jp

フェノール C₆H₅OH は芳香環と OH 基を有する最も基本的な有機化合物である.フェノールは室温において OH 基の水素が脱離したフェノキシ C₆H₅O

として Cu(110)表面に吸着することが EELS(電子エネルギー損失分光法)を用いた実験により報告[1]されている.

本研究では Cu(110)表面に吸着したフェノキシに STM(走査型トンネル顕微鏡)の探針を 数Åまで近づけながらトンネル電流を計測することにより,基板と相互作用していたフェ ノキシの芳香環が探針と相互作用するよう変化する様子を観測した.芳香環と探針が相互 作用している状態のトンネル電流は,探針-分子-基板という電気伝導経路を通るものと考 えられ,これを芳香環が基板と相互作用しているときのトンネル電流と比較することで, フェノキシ単分子の電気伝導度を考察した.さらに,ダイマー状態のフェノキシ単分子(図

1)の電気伝導を計測した結果,モノマー状態の電気伝導 と比べておよそ3割弱の電気伝導度の減少が観測された. これは分子間相互作用が,単分子伝導に影響を与えてい ると考えられる.そこで,STMを用いたマニピュレーシ ョンにより分子間距離の異なるダイマーを作製し,ダイ マー間での電気伝導度の減少の違いについて考察した. [1]N. V. Richardson and P. Hofmann, *Vacuum* 1983, *33*, 793

 フェノキシダイマーの STM 像 Vs=50mV, I=1.0nA, 29Å×19Å

P47 Remarkably-Enhanced Speed and Capacity of Hydrogen Storage in Metal Nanocrystals Covered with Metal-Organic Framework

<u>Guangqin Li¹</u>, Hirokazu Kobayashi^{1, 2}, Hiroshi Kitagawa^{1, 2}

¹Division of Chemistry, Graduate School of Science, Kyoto University, Kitashirakawa-Oiwakecho, Sakyo-ku, Kyoto 606-8502, Japan

²JST CREST, Sanbancho 5, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075, Japan E-mail : liguangqin@kuchem.kyoto-u.ac.jp

Metal nanocrystals with concave surfaces have attracted much attention in a wide variety of applications that are related to catalysis and plasmonics. Porous materials, on the other hand, with high surface area are being evaluated for a number of applications, including gas adsorption and storage, separations, catalysis, and drug delivery. Porous materials, particularly, are interesting in the field of hydrogen adsorption and storage in recent years. In this study, we have synthesized metal hybrid material combined porous materials with metal nanocrystals for hydrogen storage. Figure 1 shows TEM images of metal nanocrystals. 50 nm

Figure 1. TEM image of metal nanocrystals

TEM image of metal nanocrystals revealed that the nanoparticles have a cubic shape and the mean diameter was estimated to be c.a. 10 nm. The metal nanocrystals were the core in metal hybrid material. The hydrogen-storage properties of metal hybrid material will be discussed.

P48 短い一次元鎖間距離を有する新規 4 本鎖 MX-tube 白金 錯体の構造と電子状態

<u>大竹研一</u>^a・大坪主弥^{a,b}・北川宏^{a,b} ^a京都大学 理学研究科 化学専攻

^bJST-CREST

E-mail : ohtakekenohtake@kuchem.kyoto-u.ac.jp

一次元ハロゲン架橋金属錯体(MX-chain)は構成要素の置換により、電子状態を系統的に 制御できることが知られている.近年、次元クロスオーバー領域における物性に注目が集 まり、複数の一次元鎖を結合した 2 本鎖 ladder 型¹や4 本鎖 tube 型²の MX 錯体が合成さ れ、鎖の本数に依存した新しい電子状態が報告された.今回我々は、tube を構成する鎖間

の相関を強めることを目的として,シアン架橋 型四角形ユニットからなる新規 4 本鎖 MX-tube 型白金錯体[(dach)PtBr(CN)]₄(NO₃)₄ (dach = 1,2diaminocyclohexane)を合成した.単結晶 X 線結 晶構造解析 100 K により得られた構造を図 1 に 示す. tube 内の最隣接白金-白金間距離が 5.0 Å となり,これまでに報告されている MX-ladder 系 や MX-tube 系の中でも最も短い鎖間距離である ことから, tube 電子系に強い鎖内相互作用の導 入されたことが期待される.当日は構造と電子 状態の詳細について報告する予定である.

図 1. [(dach)PtBr(CN)]4(NO3)4の結晶構造

P49 π-d系有機導体(DIETSe)₂FeBr_{4x}Cl_{4(1-x})における 系統的な電子状態の制御

<u>川口 玄太</u>^a, 前里 光彦^a, 北川 宏^{a,b}, 今久保 達郎^c, David Graf^d, Andhika Kiswandhi^d, James S. Brooks^d

*京都大学 理学研究科 化学専攻 固体物性化学研究室, ^bJST-CREST,

°長岡技術科学大学 工学部, ^dNHMFL

E-mail:k.genta@kuchem.kyoto-u.ac.jp

π-d 系有機導体は、伝導性π電子と局在 d 電子スピンが共存し、d 電子スピンの磁気秩序 に伴って、π電子系の担う伝導性が大きく変化するなど、磁性と伝導性に相関(π-d 相互作 用)が見られる系であり、これまでにさまざまな研究が行われている. その中でも、本研 究では、巨大な外場応答による新規物性発現を狙って、パイエルス不安定性を内在する擬

一次元系の π -*d*系を用いることとした. さらに、同形構造を有しながら、物性が大きく異なる、擬一次元系の π -*d*系有機導体 (DIETSe)₂FeCl₄ と(DIETSe)₂FeBr₄の混晶系を対象とすることで、電子状態を系統的に制御し、磁性と伝導性の相関を詳細に調べることを目的として、研究を行った.

TBA-FeCl₄ と TBA-FeBr₄ を支持電解質として用いた電解合成により混晶の合成に成功した. 単結晶 X 線構造解析から,母物質と同形であることが確認された.得られた混晶の単結晶を用い,磁場・圧力などさまざまなパラメーターを変化させて抵抗測定や磁気トルク 測定などを行ったところ,混晶化により,電子状態が系統的に制御できていることが明らかとなった.

P50 多孔性配位高分子ナノ薄膜が示す特異な吸脱着挙動

<u>坂井田 俊</u>¹, 大坪 主弥^{1,2}, 坂田 修身³, 藤原明比古⁴, 北川 宏^{1,2} ¹京都大学 理学研究科 化学専攻 固体物性化学研究室

²JST-CREST, ³NIMS/SPring-8, ⁴JASRI/SPring-8

E-mail : sakaida@kuchem.kyoto-u.ac.jp

【緒言】多孔性配位高分子は結晶内部のナノ細孔におけるゲスト分子の吸着・脱着などの 様々な物性を示すことが知られ, 基板上に薄膜として構築することで吸蔵や触媒といった 複数の機能を集積させた新規材料の開発が期待されている.本研究では Layer-by-Layer 法に より Hofmann 型多孔性配位高分子 Fe(py)₂[Pt(CN)₄] (py = pyridine)(1)を金属基板上に結晶 性ナノ薄膜として構築し, さらに *in situ* X 線回折(XRD)測定によりゲスト分子の存在下 でナノ薄膜が示す特異な構造変化を観測することに成

功したので報告する.

【実験・結果】Layer-by-Layer 法により過剰量ピリジンの存在下で面内ユニット分子のエタノール溶液に室 温下で浸漬する操作を1サイクルとし、30サイクル繰り返して積層することで1のナノ薄膜を構築した(図 1).放射光を用いた XRD 測定および微小角 X 線回折

(GIXRD)測定により薄膜の構造評価を行い,面内と 面外方向に配向性を有する結晶性ナノ薄膜であること を確認した.さらに1の粉末試料は吸脱着挙動を示さ

ないにも関わらず,作製したナノ薄膜について相対圧を制御したガス雰囲気下での in situ XRD 測定を行った結果,相対圧の増減に伴って格子の可逆的な膨張/収縮が生じる様子を観 測することに成功した.これはナノ薄膜化することによりバルク結晶では見られない特異 的なゲスト分子吸脱着を示すことを強く示唆している.

図1 薄膜作製の模式図

Se

DIETSe

P51 新規の三角形環状白金錯体, [(tmeda)Pt(azpy)]₃(PF₆)₆・13H₂O

橋口 良太^a, 大坪 主弥^{a,b}, 大津 英揮^c, 北川 宏^{a,b,c}
 ^a京都大学 理学研究科 化学専攻, ^bJST-CREST, ^c京都大学 iCeMS
 E-mail:ryo-hashi@kuchem.kyoto-u.ac.jp

高い設計性を有する超分子錯体の中でも,多核環状錯体は最も単純な 有限構造を有している点で特に関心を集めている.しかし,平面四配位 構造をとる Pt, Pd を金属種として用いた場合,構造的な歪みを必要とす

る三角形環状錯体の構築には特殊な合成戦略が要求され、その結果、構造まで明らかになっている三角形環状錯体は少数しか存在しない.

今回, 我々は(tmeda) Pt^{2+} (tmeda = tetramethylethylenediamine) ユニットと azpy (azpy = 4,4'-azopyridine)ユニットの自己集合を 用いて, 新規の三角形環状白金錯体, [(tmeda)Pt(azpy)]₃-(PF_6) $_6$ ·13 H_2O を合成した[1]. 自己集合の様子を ¹H NMR スペク トルを用いて追跡し, 1 週間ほどで三角形錯体と他の錯体の成 分との平衡状態に達することが観察された. また, 三角形錯体 と他の錯体との混合物から, H 字管を用いた単結晶化により三 角形錯体のみを分離することに成功し, 単結晶 X 線構造解析 により結晶構造を決定した. 結晶構造解析の結果, この錯体は 一辺がおよそ 2.1 nm の三角形をしており, およそ 33 Å²の空孔 を持つことが示された.

図 2 [(tmeda)Pt(azp)]₃(PF₆)₆• 13H₂O の結晶構造

[1]R. Hashiguchi, et al., Chem. Lett., in press.

P52 Ni ナノ粒子/多孔性配位高分子複合体の合成とその物性

<u>向吉</u> <u>唐</u>^a, 小林 浩和 ^{a,b}, 山田 鉄兵 ^d, 前里 光彦 ^a, 北川 宏 ^{a,b}, 久保田 佳基 ^c, 山本 知一 ^{b,d}, 松村 晶 ^{b,d} ^a京大院理, ^bJST-CREST, ^c阪府大院理, ^d九大院工 E-mail : mukoyoshi@kuchem.kyoto-u.ac.jp

【緒言】金属イオンと有機配位子からなる多孔性配位高分子(MOF)と金属ナノ粒子を組み 合わせた複合体は既存のナノ物質とは異なる化学的・物理的性質を発現することから,近 年注目を集めている.本研究では MOF の熱分解を用いて Ni ナノ粒子/MOF 複合体を作製 し,その物性を調べることを目的とした.

【実験と結果】前駆体として Ni イオンを含む MOF, Ni₂(dhtp)(H₄dhtp = dihydroxyterephthalic acid)を用い,真空下で加熱して熱分解反応により複合化を行った.粉 末 X 線回折(XRD)測定により,得られた複合体の構造を調べたところ,Ni₂(dhtp)とNi ナノ 粒子の両方に由来する回折パターンが観測された(図).透過型電子顕微鏡(TEM)観察,走査

型透過電子顕微鏡(STEM)観察およびエネルギー分散型 X 線分光(EDX)により, 粒径 2~5 nm 程度の Ni ナノ粒子が MOF の内部に高分散化していることがわかった. さらに, 加熱温度や時間によって Ni ナノ粒子のサイズや Ni ナノ粒 子と MOF の組成比を制御できることが明らかとなった. また磁化率測定から,得られた複合体は Ni のナノ粒子に 特徴的な磁性を有することがわかった. 当日は詳細な物性 について議論する.

Ni ナノ粒子/MOF 複合体の XRD パターン ((a)Ni₂(dhtp), (b)Ni ナノ粒子/MOF 複合体)と TEM 像

P53 配位高分子で保護されたヨウ化銀ナノ粒子の合成と相挙動

山本 貴之^a, 山田 鉄兵^b, 小林 浩和^{a,c}, 北川 宏^{a,c,d} ^a京都大学 理学研究科 化学専攻 固体物性化学研究室 ^b九州大学 分子システム科学センター

^cJST-CREST

^d京都大学物質-細胞統合システム拠点

E-mail : tyamamoto@kuchem.kyoto-u.ac.jp

バルクのヨウ化銀 (AgI) は 147 \mathbb{C} 以上で β/γ 相から α 相に構造相転移し, 銀イオン の副格子融解により超イオン伝導性を示す. 最近, 我々は AgI の粒径を 10 nm 程度まで減 少させると α 相が室温付近まで安定に保持できることを見出した.一方,金属イオンを 有機配位子で架橋した多孔性配位高分子(PCP)は規則的なナノサイズ空間を有し、特異 な機能を発現することができる. 本研究では, AgI/PCP 複合体を作製し, PCP の被覆に伴 う Agl ナノ粒子の相挙動について調べた.

合成は液相反応により行った.得られた AgI/PCP 複合体 の粒径と構造について調べるため,透過型電子顕微鏡 (TEM) 観察,エネルギー分散型X線分析 (EDX) および 粉末X線回折 (PXRD) 測定を行い、その結果から複合体中 にナノメートルオーダーの AgI ナノ粒子が存在しているこ とを確認した.また、示差走査熱量測定(DSC)により複 合体中の AgI ナノ粒子の相転移挙動を調べた. 詳細は当日 図 AgI/PCP 複合体の TEM 像 報告する.

P54 パイロクロア型格子磁性体 Cu₂(OH)₃Cl の 3 次元フラストレーションが 生む新奇逐次相転移

佐藤衆一 ª, 小山田明 ª, 西山昌秀 ª, 伊藤哲明 b, 前川覚 ª, 萩原雅人 °, 鄭旭光 °,高橋弘樹 ª,大井修吾 ª,小木曽哲 ª

*京都大学 人環・環境学研究科, *東京大学 工学系研究科, ° 佐賀大学 理工学部

E-mail : sato.shuichi.68x@st.kvoto-u.ac.jp

 $Cu_2(OH)_3Cl$ は, s = 1/2の量子スピンをもつ Cu^{2+} が図1のように四面体の頂点に位置し, その各頂点を共有して結合したパイロクロア格子3次元フラストレート磁性体である.

 $\theta_{CW} = -190 \text{ K}$ という Weiss 温度に対し、磁気秩序が低 温まで抑制され, 18.1 K と 6.2 K で逐次相転移する.相 転移が逐次的に起こる原因や各相での磁気状態について, 大きな興味と対照的に長らく不明のままであった.

我々は¹H-NMR 実験を行い、図1のように低温相の 磁気構造を詳細に決定した.中間相では NMR スペクト ルから磁気秩序が明確に存在すると同時に、スピン格子 緩和率から常磁性的な強いスピン揺らぎが共存すること を明らかにした.更に、中間相から低温相にかけて、対 称性が回復,または SU(2)の高い対称性を反映した新奇 な対称性の変化を伴う転移をすることも分かった.この 逐次転移は図 1 青線で示す Cu1 反強磁性鎖と、赤線で 示す Cu2 および Cu3 の作る強磁性鎖との間で生じるフ ラストレーションから Cu1 が部分的に揺らぐ特異な中 間相を経るものであると考えられる.

10 nm

 $\boxtimes 1$ Cu₂(OH)₃Cl 矢印は低温相磁気構造,青および赤 線は相関の強い1次元鎖を表わす.

P55 かごめ格子反強磁性体 Rb₂Cu₃SnF₁₂における スピンギャップ状態と磁場誘起スタッガードモーメント 田代 大志^a,西山 昌秀^a,伊藤 哲明^b,小山田 明^a,前川 覚^a, 矢野 みどり^c,小野 俊雄^d,田中 秀数^c ^a京都大学 人間・環境学研究科 ^b東京大学 工学系研究科 ^c東京工業大学 理工学研究科 ^d大阪府立大学 理学系研究科 E-mail: tashiro.hiroshi.23w@st.kyoto-u.ac.jp

Rb₂Cu₃SnF₁₂ は *s* =1/2 の磁性イオン Cu²⁺が反強磁性的に結合したかごめ格子反強磁性体である.かごめ格子が風車状に歪み $J_1 \approx 200 \text{ K} > J_2 > J_3 > J_4 \approx 100 \text{ K}$ の4種の最近接交換相互作用を持つために,基底状態はスピンギャップを持つ VBS 状態となっている.またかごめ格子はスピンサイト間に反転対称中心を持たないため,反対称な相互作用であるDzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用が存在する可能性がある.我々はCu-NQR におけるスピン-格子緩和率の温度依存性から,磁化率で観測された 20K のスピンギャップ[1]よりも大きなエネルギーギャップを観測し,スピンギャップよりも高いエネルギー領域に,大きな状態密度を持つトリプレット励起状態が存在することを明らかにした[2].また磁化率が20 K 以下でスピンギャップの形成に伴い急激に減少する一方で,¹⁹F-NMR スペクトルシフトの温度依存性から,低温で急激に増大する,磁化率に比例しない内部磁場の存在を見出し,この内部磁場が DM 相互作用によってシングレット基底状態とトリプレット励起状態が混成することで発生する磁場誘起スタッガードモーメントによるものであることを明らかにした.

 K. Morita, M. Yano, T. Ono, H. Tanaka, K. Fujii, H. Uekusa, Y. Narumi, and K. Kindo: J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 043707.

[2] H. Tashiro, M. Nishiyama, A. Oyamada, T. Itou, S. Maegawa, M. Yano, T. Ono and H. Tanaka: J. Phys.: Conf. Ser. 320 (2010) 012052.

P56 フラストレートしたヘビーフェルミオン磁性体 UNi₄B の 新奇秩序状態

<u>猪原崇生</u>A,小山田明A,伊藤哲明A,前川覚A,李徳新B,芳賀芳範C A京都大学 人間・環境学研究科 相関環境学専攻 B東北大金研,C原子力機構

E-mail: inohara.takao.54x@st.kyoto-u.ac.jp

最近フラストレート金属磁性体での異常ホール効果が注目を 集めている.実際,スピンカイラリティを起源とする非従来型 のホール効果がいくつかの物質で報告されている.5f 電子系三 角格子反強磁性体 UNi₄B は金属で,電気伝導性とフラストレー ションを併せ持っているために,非従来型の異常ホール効果が 期待される物質である.UNi₄B は,磁性イオンである U³⁺イオン が三角格子を形成し,強い容易面型の磁気異方性を持っている. 転移温度 T_N = 20K 以下での磁気構造は,三角面上でUモーメン トの 2/3 が渦状に秩序化し,残りの 1/3 が渦の中央で常磁性状態 のまま存在することが中性子回折により明らかにされている.

今回,単結晶試料のホール抵抗率の測定を行った.図1にホ ール抵抗率 ρ_{xy} の温度変化を示す.25Kにおける磁場に比例する ρ_{xy} の振舞いは,正常ホール効果と磁化による従来型の異常ホー ル効果によるものと考えられる.一方,5K以下での ρ_{xy} は磁場 に比例しない異常を示し,非従来型のホール効果が現れている ことを示唆している.核スピン横緩和率 T_2 の結果から, ρ_{xy} の 異常と同じく5K以下で,スピン凍結が起こることが分かった.

図 3 外部磁場を三角面に 垂直に印加し,三角面に平 行に電流を流して得られた ρ_{xx}の温度依存性.

P57 スピン液体物質の圧力下 ¹³C-NMR

<u>渡辺 恵里</u>^a, 伊藤 哲明^b, 前川 覚^a, 宮川 和也^b, 鹿野田 一司^b, 久保 和也^c, 加藤 礼三^d ^a京都大学 人間・環境学研究科 相関環境学専攻 ^b東京大学 工学系研究科 物理工学専攻 ^c北海道大学 電子科学研究所 ^d理化学研究所 E-mail: watanabe.eri.33u@st.kyoto-u.ac.jp

二次元三角格子有機物質 EtMe₃Sb[Pd(dmit)₂]₂ は Pd(dmit)₂ が組んだダイマー[Pd(dmit)₂]₂ 上 にスピン 1/2 の電子が 1 つ存在する Mott 絶縁体である.正三角格子に近い格子をもつため, 強いフラストレーション効果により量子スピン液体状態が実現している.この物質の静水 圧力下の電気抵抗は 5~6kbar で急激に減少していき,この圧力付近に Mott 転移があると考 えられるが,高圧下においても低温でわずかな抵抗の増大が観測されている.この物質の 圧力下の電子状態を探るため,圧力下 ¹³C-NMR 測定を行った.

静水圧下の 300K から 2K までのスピン-格子緩和率 T_1^{-1} と NMR スペクトルの温度依存 性を調べた結果, T_1^{-1} は 5kbar 以下の低圧側と 6kbar 以上の高圧側で低温の振る舞いが大き く変わった.低圧側は常圧と同じ振る舞いをし,Mott 転移直前までスピン液体状態が実現 していると考えられる一方,高圧側では低温で T_1^{-1} が温度に比例するコリンハ的振る舞い が観測され,MHz 領域のスピンダイナミクスは通常の金属的性質をもっていることがわか った.しかしながら, T_2^{-1} に関しては低温側で増大していく振る舞いが見られ,kHz 領域 の遅いゆらぎが発達しているという特異な振る舞いが実現していることがわかった.

P58 Fe 系 n-カーバイド型窒化物の磁性

安藤 拓矢, 和氣 剛, 田畑 吉計, 中村 裕之 京都大学 工学研究科 材料工学専攻 磁性物理学分野 E-mail: ando.takuya.34w@st.kyoto-u.ac.jp

立方晶 η-カーバイド型化合物は, 遷移金属 T が 16d サイトと32e サイトを占め, T(16d)のパイロクロア格子に T(32e)の正四面体が貫入する星型四

面体副格子を有する. 我々は, η-カーバイド型窒化物 Fe₃Mo₃N において遍歴電子メタ磁 性転移や非フェルミ液体的な挙動を報告している[1]. このことは Fe₃Mo₃N が強磁性量子臨 界点近傍の物質であることを示している. また, Co 置換効果の研究から本系における異常 なふるまいは星型四面体格子における幾何学的フラストレーション効果の現れと考えてい る[2].

最近, Ge 置換体 Fe₂GeMo₃N において, T_N =455Kの反強磁性転移が報告された [3]. 磁性 原子が希釈されているのにも関わらず, 磁性が強化されているのが興味深い.

そこで、本研究では Fe_3Mo_3N および Fe_2GeMo_3N のより深い理解のために Ge 置換系 $(Fe_{1-x}Ge_x)_3Mo_3N$ の合成を試み、固溶域を明らかにするとともにその磁性を評価した. 粉末 X 線回折を用いた相同定から、x=0.33 まで連続的に Ge が固溶することを明らかにした. また、帯磁率は x=0 では 75K 付近にブロードなピークが見られたが、x=0.166 では消失し

ている(図). x=0.33 の基底状態は反強磁性である が, x=0.166 の基底状態は不明である. その他, 詳細 は当日報告する.

[1] T. Waki, et al., J. Phys. Soc. Jpn, 79 (2010) 043701.

[2] T. Waki, et al., EPL, 94 (2011) 37004.

[3] Battle, PD et al., J. Mater. Chem., 22 (2012) 15606

P59 M 型 Sr フェライトの La-Co 置換系単結晶の合成と物性

下田 愛子, 和氣 剛, 田畑 吉計, 中村 裕之 京都大学大学院 工学研究科 材料工学専攻 E-mail:shimoda.aiko.46u@st.kyoto-u.ac.jp

Sr マグネトプランバイト型(M 型)フェライト(SrFe₁₂O₁₉)は, Fe が磁性を

示す永久磁石のひとつであり、低価格・化学的に安定・元素戦略上有利なことから市場の 大部分を占めている. Sr と Fe の一部を La と Co に置換すると保持力が向上するが、その機 構について明らかでないことが多い. SrFe₁₂O₁₉には結晶学的に異なる 5 つの Fe サイトが存 在し、Co の置換サイトの同定がその解明に重要であるが、中性子回折やラマン散乱、メスバ ウア、NMR などの各種測定手段によって、統一的な見解が得られていないことが問題とな っている.

そこで本研究では、より詳細な情報を得るため、La と Co を置換した SrFe₁₂O₁₉単結晶の 作製を試みた. Na₂O フラックス法による単結晶育成を行った結果、La と Co を置換した SrFe₁₂O₁₉の一連の単結晶を得ることができた. MPMS による測定の結果、マクロな性質と して異方性磁界を正確に見積もることができ、置換とともに増加することを明らかにした. 今後は単結晶試料を用いた微視的な測定から、サイト同定と異方性増大の起源の解明が課 題である.

P60 フェリ磁性体 SrFe12O19 における逆スピンゼーベック効果の観測

<u>山田広信</u>栗山公威田畑吉計和氣剛中村裕之 京都大学工学研究科材料工学専攻磁性物理学

E-mail: yamada.hironobu.37v@st.kyoto-u.ac.jp 近年, 固体中のスピン角運動量の流れとして, スピン流という概念が確立さ れつつある.スピン流は,絶縁体中を熱損失なく伝わるなど,電流にはない性質を持って いるため,様々な応用が考えられている.ここ最近の精力的な研究により, スピン流に よって横方向に電圧が誘起されるスピンホール効果[1]や,温度勾配によってスピン流が誘 起されるスピンゼーベック効果[2]といった, スピン流を主役とした新現象が多く発見さ れた.

我々は、スピン流により温度勾配が発生するという逆スピンゼーベック効果の観測を目 標とした研究を行なってきた.スピン流にとって電場と同じ役割を果たす磁場勾配を電荷 自由度の無い磁性絶縁体に印加することで純スピン流を流し、そのスピン流によって発生 する温度差を観測する試みである.これまでの研究で、反強磁性絶縁体である MnF_2 にお いて、磁場勾配による温度差の発生を確認している[3].下図は、 MnF_2 で観測された温度 勾配•*T*/*T* と磁場勾配•*B* との比例係数(熱スピン係数 *k*)の温度依存性を示している. MnF_2 の反強磁性領域(ネール温度 $T_N = 67.19$ K 以下)では、常磁性領域に比べての値 *k* が顕著に 大きくなっている.また、異方性があることも分かる.

今回は、フェリ磁性体である $SrFe_{12}O_{19}(T_c = 733 \text{ K})$ を試料とした. $SrFe_{12}O_{19}$ は自発磁化を持っており、 MnF_2 と異なり、大きな一様磁場を掛けなくても、温度勾配が見られると期待される.

- T. Kimura et al., Phys. Rev. Lett. 98, 156601 (2007).
- [2] K. Uchida et al., Nature 455, 778 (2008).;
 K.Uchida et al., Nature Mater. 9, 894 (2010).
- [3] 栗山公威他, 日本物理学会第 67 回年次大会 24aPS-23

P61 強磁性量子臨界現象を示す遍歴電子磁性体

(Fe_{1-x}Co_x)₃Mo₃Nの熱膨張・磁歪測定 井吉悠太 ^a,田畑吉計 ^a,和氣剛 ^a,中村裕之 ^a

^a京都大学 工学研究科 材料工学専攻 磁性物理学研究室

E-mail: iyoshi.yuta.86v@st.kyoto-u.ac.jp

η-カーバイド型化合物である Fe₃Mo₃N は立方晶に属し,空間群は Fd3m である. Fe が 16d 及び 32e サイト, Mo は 48f サイト, N は 16c サイトを占め,磁性原子である Fe が三 角形を基調とした星形四面体格子を組んでいることから,新たな遍歴電子フラストレート 系の候補物質として期待されている. 我々はこれまでに, Fe₃Mo₃N が圧力などのパラメー 夕調節なしで 3 次元強磁性量子臨界点近傍の異常な振る舞いを示すことや, Fe を Co 置換 することで強磁性が発生することなどを報告してきた[1,2]. (Fe_{1-x}Co_x)₃Mo₃N はわずか 5% 程度の Co 置換(x = 0.05)で強磁性が発生し, x = 0.20 で最大の $T_{\rm C}$ を取り,その後単調に転 移温度が減少し, x = 0.65 程度で再び強磁性が消失する. 我々は, Fe₃Mo₃N が強磁性量子 臨界点近傍なのは偶然ではなく,電子相関が強く本来強磁性になるはずが,星形四面体格 子のフラストレーションによって無理矢理抑えられた結果,と考えている.

本研究では、(Fe_{1-x}Co_x)₃Mo₃N の熱膨張・磁歪測定を行い、その強磁性量子臨界現象を調べている.以前にも Fe₃Mo₃N について熱膨張測定を行ったが[3],測定精度が不十分であった.そこで今回は、特に低温での精度を上げる工夫をして測定を行った結果を報告する.

[1] T. Waki et al., JPSJ 79 (2010) 043701.

[2] T. Waki et al., EPL, 94 (2011) 37004.

[3]山本将貴他, 日本物理学会 2011 年秋期大会 21aPS-49

P62 低温環境下の生体膜における長鎖多価不飽和脂肪酸の生理機能

<u>川本 純</u>^a, 水谷 彩乃^a, 佐藤 智^b, 江崎 信芳^a, 栗原 達夫^a

*京都大学 化学研究所 分子微生物科学

^b京都大学 低温物質科学研究センター

 $E\text{-mail}:jun_k@mbc.kuicr.kyoto-u.ac.jp$

ドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)は,抗炎 症作用や抗腫瘍作用など,人の健康に有益な効果をもたらす生理活性脂質

である. これらの脂肪酸はメチル末端から三番目の炭素に二重結合を有することから ω3 系多価不飽和脂肪酸と総称される. DHA や EPA は細胞膜を構成するリン脂質のアシル鎖 として存在し、膜の流動性や曲率、膜圧や弾性など膜の様々な物理化学的特性を変化させ ることで、周辺の膜タンパク質の機能を制御していることが予想される. 一方、DHA や EPA の機能発現機構の詳細は明らかでない. 本研究では、EPA 産生性微生物 Shewanella livingstonensis Ac10 をモデル生物とし、EPA の生理機能の解明を試みた. 本菌の EPA 生 合成遺伝子破壊株 (ΔEPA) において、外膜チャンネルタンパク質 (Omp74) が野生株とは 異なるフォールディングを形成していたことから、Omp74 と EPA 含有リン脂質の相互作 用の存在が示唆された. 精製した Omp74 を EPA 含有リン脂質を含む人工膜に再構築し た結果、EPA 存在下で 可溶化した Omp74 は速やかに人工膜に組み込まれ、疎水的環境 下での二次構造形成が促進されていたことから、EPA は Omp74 の膜内でのフォールディ ングを促進する分子シャペロン様の機能を有していることがわかった.

P63 低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 の 細胞分裂関連タンパク質の機能解析

<u>永久 由利絵</u>^a, 青柳 美穂^a, 川本 純^a, 江崎 信芳^a, 栗原 達夫^a ^a京都大学 化学研究所 分子微生物科学領域

E-mail : eikyu @mbc.kuicr.kyoto-u.ac.jp

グラム陰性菌の細胞分裂は、細胞分裂関連タンパク質群が細胞の中心部位で細胞分裂 装置を形成することから開始する. ABC トランスポーターホモログの FtsEX は、細胞分 裂装置に含まれるタンパク質複合体である. 当研究室では、南極海水から単離されたグラ ム陰性桿菌 Shewanella livingstonensis Ac10 のエイコサペンタエン酸 (EPA) の機能解析を 進めている. EPA 生合成遺伝子を破壊した EPA 欠損株は、生育速度が低下し伸長した多 核構造を示したことから (図 1)、EPA の欠損は細胞分裂に異常をきたすことが明らかとな った. また、EPA 含有リン脂質が細胞分裂サイトへ局在することも明らかにしている.

そこで本研究では, S. livingstonensis Ac10 や人工脂質二重膜を用いた FtsEX の膜局在性 における EPA の影響を解析することによって, S. livingstonensis Ac10 の細胞分裂機構に おける FtsEX と EPA の相互作用機構の解明を試みた.

その結果, EPA は FtsE の細胞膜局在性を制御し ていることが明らかになった.一方, EPA は FtsE の *in vitro* 膜結合性には影響しなかったことから, EPA は FtsX の構造形成に関与することで,細胞分裂サ イトにおける FtsEX 複合体の形成を制御している ことが示唆された.

図 1 多核構造を持つ伸長した EPA 欠損株. DNA 染色 (左), 細胞膜染 色 (中央), 重ね合わせ (右)

P64 EPA 生合成遺伝子破壊が低温菌外膜タンパク質の生合成におよぼす影響

<u>杉浦 美和</u>ª, 川本 純^ª, 栗原 達夫^ª

*京都大学 化学研究所 分子微生物科学領域

E-mail : sugiura@mbc.kuicr.kyoto-u.ac.jp

【目的】南極海水由来の低温菌 Shewanella livingstonensis Ac10 は、低温誘導的に高度不 飽和脂肪酸の一種であるエイコサペンタエン酸 (EPA) を細胞膜リン脂質のアシル鎖と して生産する.本菌の EPA 生合成遺伝子破壊株 (ΔEPA) は、低温での生育速度が低下し たことから、EPA は本菌の低温環境適応に重要であることが示された.さらに、外膜チャ ンネルタンパク質のホモログ (Omp417) の生産量が、ΔEPA で顕著に低下することがわか った.このことから EPA と Omp417 の相互作用の存在が示唆された.本研究では、 Omp417 の生産における EPA の生理的役割の解明を目的とし、Omp417 のフォールディ ングに EPA 含有リン脂質がおよぼす影響や、Omp417 の遺伝子発現における EPA の生 理的役割を解析した.

【方法・結果】 Omp417 のフォールディングにおける EPA 含有リン脂質の影響を解析 するため、EPA 含有リン脂質を含むリポソームと含まないリポソームを用いた *in vitro* 再 構成実験を行い、リポソームと混合した Omp417 の Trp 蛍光の経時的な測定と、CD ス ペクトルの測定によってフォールディング状態を解析した.その結果、Omp417 の二次構 造形成や Trp 残基周辺環境は EPA 含有リン脂質の有無によって有意に変化しないことが 示された.一方、野生株と ΔEPA における *omp417* の転写量を、リアルタイム RT-PCR によって解析した.その結果、ΔEPA における *omp417* の転写量は、野生株の 100 分の 1 以下に抑制されていることがわかった.しかし、ΔEPA に EPA を外部添加しても、 *omp417* の転写量は回復しなかった.以上の結果から、本菌には EPA の生合成酵素、あ るいは生合成中間体による *omp417* の発現調節機構が存在することが示唆された.

P65 スピネル系バリアを有するトンネル磁気抵抗素子 におけるショット雑音および 1/f 雑音

<u>田中 崇大</u>^a, 荒川 智紀^a, 知田 健作^a, 西原 禎孝^a, 千葉 大地^a, 小林 研介^b, 小野 輝男^a, 介川 裕章^c, 葛西 伸哉^c, 三谷誠司^c ^a京都大学 化学研究所,^b大阪大学 理学研究科,^b物質·材料研究機構 E-mail:t.tanaka@scl.kyoto-u.ac.jp

トンネル磁気抵抗(TMR)素子とは、強磁性体/絶縁体/強磁性体という構造をもち、その抵抗が強磁性体層の相対的磁化配向によって変化する素子のことである.素子抵抗は、強磁性体層の磁化方向が同じ(平行状態)のときに小さく、逆向き(反平行状態)のときに大きい. 2004 年に、絶縁体が MgO 結晶である TMR 素子が作製され、巨大な抵抗変化が報告され、電子の運動量とスピンの向きが保存するコヒーレントトンネルが重要な役割を果たしていると言われている.

トンネル過程を定量的に評価する手法として、平均からのずれを測定する電流雑音測定 がある.代表的な電流雑音として、ショット雑音がある.ショット雑音は、電子の分配過 程に起因するため、その大きさの指標となるファノ因子を見積もることでトンネル過程に 関する定量的に評価できる.

本研究は、TMR 素子における電子のトンネル過程の詳細を明らかにすることを目的とし て、スピネル系バリアを有する TMR 素子について、ショット雑音測定を行った.スピネ ル MgAl₂O₄ は Fe に対して格子不整合が極めて小さいため(1%以下)、欠陥が非常に少ない 素子が作製できるとされ、巨大な TMR 効果も報告された.しかし、スピネル系 TMR にお いてコヒーレントトンネルが起きることはまだ確認されていなかった.本研究では、スピ ネル系 TMR 素子においてもコヒーレントトンネルが起きていることを示唆する結果を得 た.

P66 電流雑音測定による量子ホール効果ブレークダウン前駆現象の観測

<u>知田健作</u>, 荒川智紀, 松尾貞茂, 西原禎孝, 田中崇大, 町田友樹^A, 小林研介^B, 小野輝男

京都大学化学研究所,^A東京大学生產技術研究所,^B大阪大学理学研究科

E-mail : chida@scl.kyoto-u.ac.jp

量子ホール状態における無散逸な電気伝導は電流や電圧の印加により 崩壊する.我々はバイアス電圧の印加による量子ホール状態の崩壊を伝 導度の量子化値からのずれ,および有限の電流雑音の発生として観測し

導度の量子化値からのずれ,および有限の電流雑音の発生として観測し た.また,伝導度が量子化値からずれるよりも小さなバイアス電圧において量子ホール効 果ブレークダウンの前駆現象と考えられる有限の電流雑音を観測した.

測定は希釈冷凍機中 50 mK において二次元電子系に垂直に磁場を印加し,長さ 300 µm で幅 20 µm のホールバーを用いて行った.伝導度測定はロックイン法により行った.電流

雑音測定では, 共鳴回路により取り出された 2.5 MHz の電流雑音を, 低温増幅器を用いて増幅した.

図1に磁場 4.2 T のもとで 9 mV のバイアス電圧を 20 分間印加したときの伝導度と電流雑音を示す. 伝導 度が量子化値からずれていないにもかかわらず有限の電 流雑音が観測された. また, 電流雑音は数分のオーダー で経時変化する. これは局在準位への電子のトンネル過 程に起因するものと考えられる.

